



Linux SPINAND 开发指南

版本号: 1.4
发布日期: 2024.10.23

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2021.02.01	AW1669	建立初始版本
1.1	2022.11.10	AW1669	添加 5.10 内核配置说明
1.2	2023.12.11	AW2080	添加 4.9、5.15 内核配置说明和内核源码目录
1.3	2024.08.14	AW2155	添加 uboot2023 配置说明
1.4	2024.10.23	AW1669	新增了开发功能、日志分析、调试方法和 FAQ 章节



目 录

1 概述	1
1.1 编写目的	1
1.2 适用范围	1
1.3 相关人员	1
2 术语、缩略语及概念	2
3 流程设计	3
3.1 体系结构	3
3.2 源码结构	4
3.2.1 Linux4.9/5.4	4
3.2.2 Linux5.4-ansc/5.10/5.15	4
4 模块配置	6
4.1 uboot 模块配置	6
4.1.1 uboot-2018	6
4.1.2 uboot-2023	7
4.2 kernel 模块配置	9
4.2.1 Linux4.9	9
4.2.2 Linux5.4	10
4.2.3 Linux5.4-ansc/5.10/5.15	13
4.2.4 env.cfg	18
5 关键数据定义与接口说明	19
5.1 关键数据定义	19
5.1.1 flash 设备信息数据结构	19
5.1.2 flash chip 数据结构	20
5.1.3 aw_spinand_chip_request	21
5.1.4 ubi_ec_hdr	22
5.1.5 ubi_vid_hdr	22
5.2 关键接口说明	25
5.2.1 MTD 层接口	25
5.2.1.1 aw_spinand_erase	25
5.2.1.2 aw_spinand_read	25
5.2.1.3 aw_spinand_read_oob	26
5.2.1.4 aw_spinand_write	26
5.2.1.5 aw_spinand_write_oob	26
5.2.1.6 aw_spinand_block_isbad	27
5.2.1.7 aw_spinand_block_markbad	27

5.2.2	物理层接口	27
5.2.2.1	aw_spinand_chip_read_single_page	27
5.2.2.2	aw_spinand_chip_write_single_page	28
5.2.2.3	aw_spinand_chip_erase_single_block	28
5.2.2.4	aw_spinand_chip_isbad_single_block	28
5.2.2.5	aw_spinand_chip_markbad_single_block	29
5.2.3	Uboot 应用接口	29
5.2.3.1	sunxi_flash_nand_probe	29
5.2.3.2	sunxi_flash_nand_init	29
5.2.3.3	sunxi_flash_nand_exit	29
5.2.3.4	sunxi_flash_nand_write	30
5.2.3.5	sunxi_flash_nand_read	30
5.2.3.6	sunxi_flash_nand_erase	30
5.2.3.7	sunxi_flash_nand_force_erase	30
5.2.3.8	sunxi_flash_nand_flush	31
5.2.3.9	sunxi_flash_nand_download_spl	31
5.2.3.10	sunxi_flash_nand_download_toc	31
6	功能开发	32
6.1	功能概述	32
6.2	开发流程	32
6.2.1	BOOT0 读取数据	32
6.2.2	uboot shell 使用	33
6.2.3	内核态访问 flash	34
6.2.4	用户态访问 flash	35
6.2.5	在 ubi 卷上模拟 mtddblock 设备，挂载块设备文件系统	36
6.3	注意事项	37
7	日志分析	38
8	调试方法	40
9	FAQ	41
9.1	dram 全盘扫描	41
9.2	启动失败	42
9.2.1	brom 启动 boot0 失败	42
9.2.2	boot0 读 uboot 失败	42
9.3	Ubifs scanning 时间过长	42
9.4	Flash 分区与使用说明大小不一致	43
9.5	fat 挂载在 mtddblock 设备上，sync 数据没有写下	45

插 图

图 3-1	UBI 架构	3
图 4-1	Support_sunxi_nand	6
图 4-2	defconfig_nand_single_plane	7
图 4-3	uboot2023_support_spinand	8
图 4-4	uboot2023_spinand_twoplane	8
图 4-5	MTD_SPINAND_UBI	9
图 4-6	UBIFS	10
图 4-7	sunxi-nand_UBI	10
图 4-8	AWNAND_CHOICE	11
图 4-9	SPINAND_Support	11
图 4-10	SUNXI_SPI_Controller	12
图 4-11	A31_DMA_support	12
图 4-12	sid_support	13
图 4-13	Support_UBIFS	13
图 4-14	menuconfig_bsp_MTD	14
图 4-15	menuconfig_bsp_single_plane	14
图 4-16	SPI_Support	15
图 4-17	SPI_Support	15
图 4-18	DMA_Support	16
图 4-19	menuconfig_MTD	16
图 4-20	menuconfig_UBI	17
图 4-21	UBIFS_Support	17
图 4-22	menuconfig_gengeral_setup_ram	18
图 5-1	PEB-LEB	25
图 6-1	sunxi flash read	33
图 6-2	hexdump	33
图 6-3	mm - md	34
图 6-4	sunxi flash write	34
图 6-5	sunxi flash read2	34
图 9-1	DragonHD tool	41
图 9-2	DragonHD tool	41
图 9-3	分区信息	43
图 9-4	UBIFS 数量类型及损耗说明	44
图 9-5	PEB-LEB	45

1 概述

1.1 编写目的

介绍 Sunxi SPINand mtd/ubi 驱动设计, 方便相关驱动和应用开发人员

1.2 适用范围

本设计适用于所有 sunxi 平台

1.3 相关人员

Nand 模块开发人员, 及应用开发人员等



2 术语、缩略语及概念

MTD: (Memory Technology device) 是用于访问存储设备的 linux 子系统。本模块是 MTD 子系统的 flash 驱动部分

UBI: UBI 子系统是基于 MTD 子系统的，在 MTD 上实现 nand 特性的管理逻辑，向上屏蔽 nand 的特性

坏块 (Bad Block): 制作工艺和 nand 本身的物理性质导致在出厂和正常使用过程中都会产生坏块



3 流程设计

3.1 体系结构

NAND MTD/UBI 驱动主要包括 5 大组件，如下图：

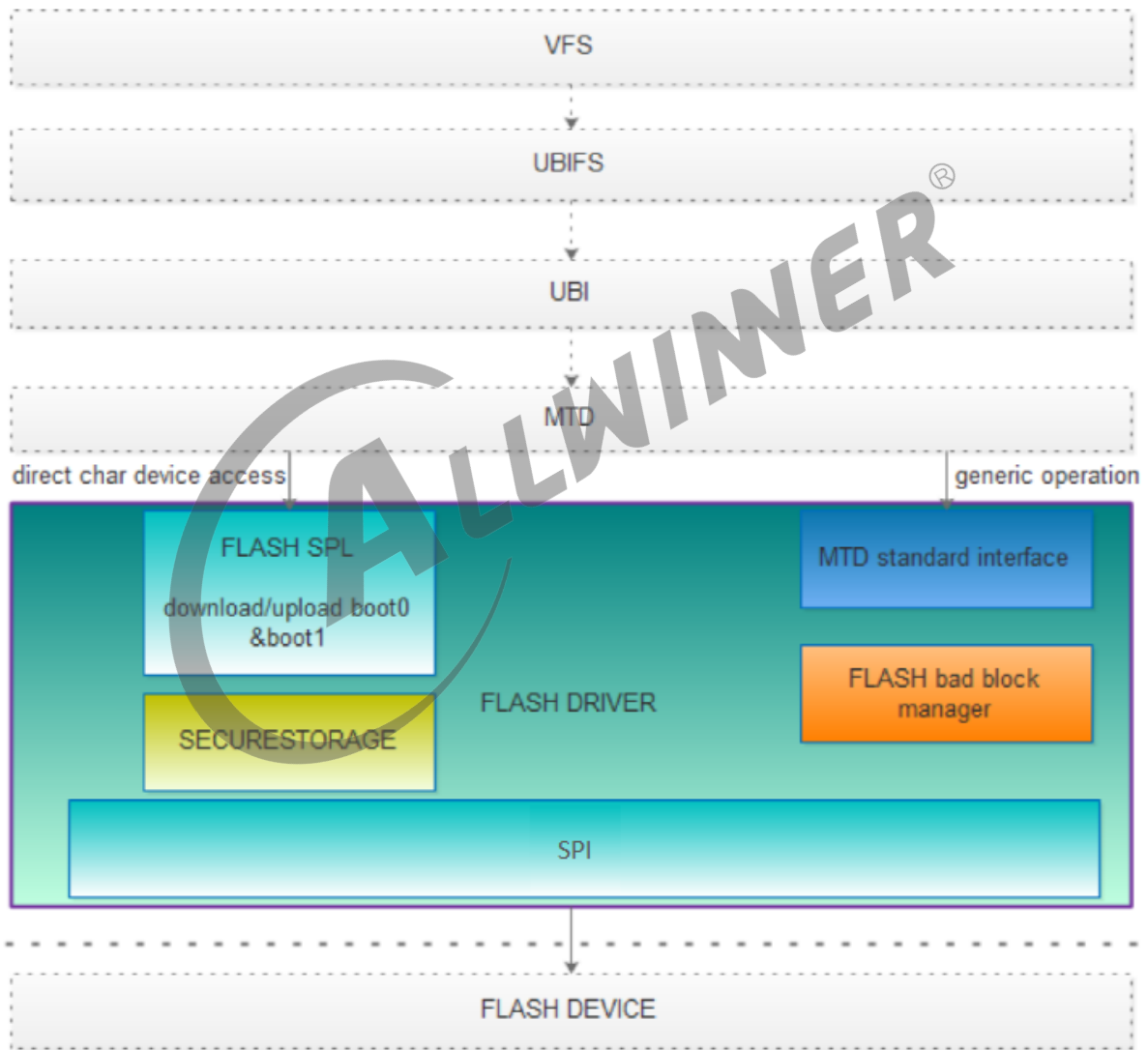


图 3-1: UBI 架构

说明：

MTD standard interface: 对接 MTD 层通用读写接口

FLASH bad block manager: 驱动层对 flash 坏块的管理

FLASH SPL: 主要是实现读写 boot0、boot1, 可用于 ioctl 对 boot0、boot1 的升级

SECURESTORAGE: 主要是给上层提供私有数据的管理

SPI: HOST 端控制器层的实现

3.2 源码结构

3.2.1 Linux4.9/5.4

kernel 源码目录: linux-4.9/drivers/mtd/awnand/spinand

```

.
├── Kconfig
├── Makefile
├── physic
│   ├── bbt.c
│   ├── cache.c
│   ├── core.c
│   ├── ecc.c
│   ├── id.c
│   ├── Makefile
│   ├── ops.c
│   └── physic.h
├── secure-storage.c
├── sunxi-common.c
├── sunxi-core.c
├── sunxi-debug.c
├── sunxi-nftl-core.c
└── sunxi-spinand.h

```

内核目录下

```

|-- include
    |-- linux
        |-- mtd
            |-- aw-spinand.h

```

3.2.2 Linux5.4-ansc/5.10/5.15

bsp 源码目录: bsp/drivers/mtd/awnand/spinand

```

├── Kconfig
├── Makefile
├── spinand
│   ├── Kconfig
│   ├── Makefile
│   ├── physic
│   └── bbt.c

```

```
| |—— cache.c
| |—— core.c
| |—— ecc.c
| |—— id.c
| |—— Makefile
| |—— ops.c
| |—— physic.h
|—— secure-storage.c
|—— sunxi-common.c
|—— sunxi-core.c
|—— sunxi-debug.c
|—— sunxi-nftl-core.c
|—— sunxi-spinand.h
```

头文件在：bsp/include/linux/mtd/

```
—— aw-spinand.h
—— aw-spinand-nftl.h
```



4 模块配置

4.1 uboot 模块配置

4.1.1 uboot-2018

Device Drivers-->Sunxi flash support-->
 Support sunxi nand devices
 Support sunxi nand ubifs devices
 Support COMM NAND V1 interface

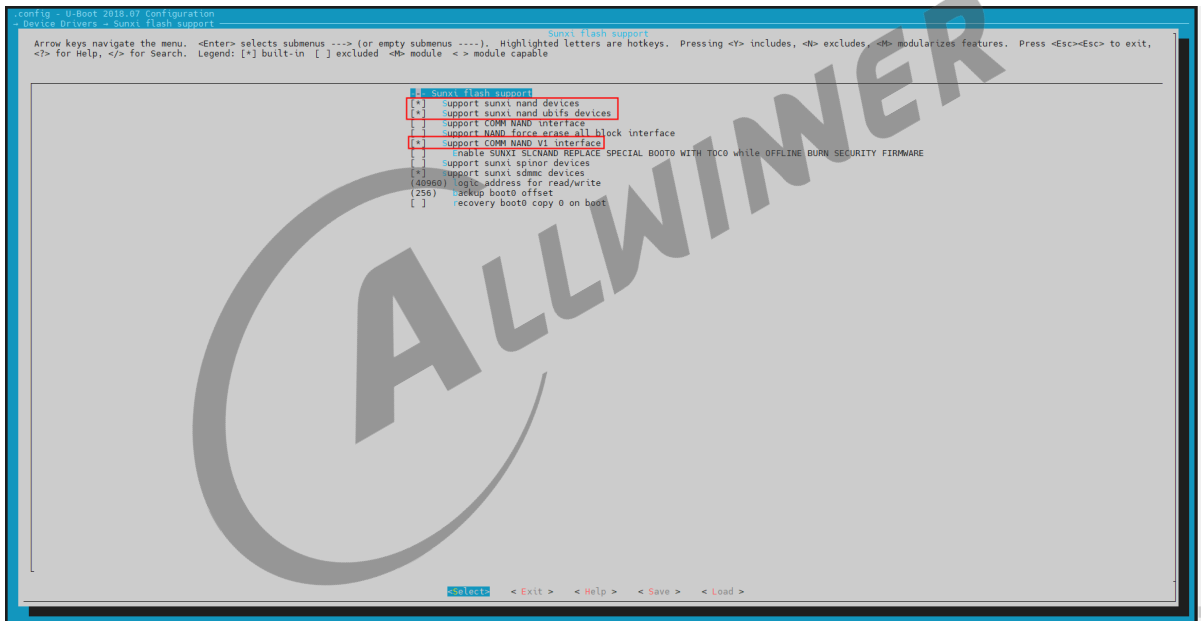


图 4-1: Support_sunxi_nand

如果内核是 Linux5.10 或 Linux 5.15，则应配置成 Single Plane（不打开 enable simulate multiplane，之前的内核版本则需要打开），如下所示：

Device Drivers → MTD Support
 enable simulate multiplane

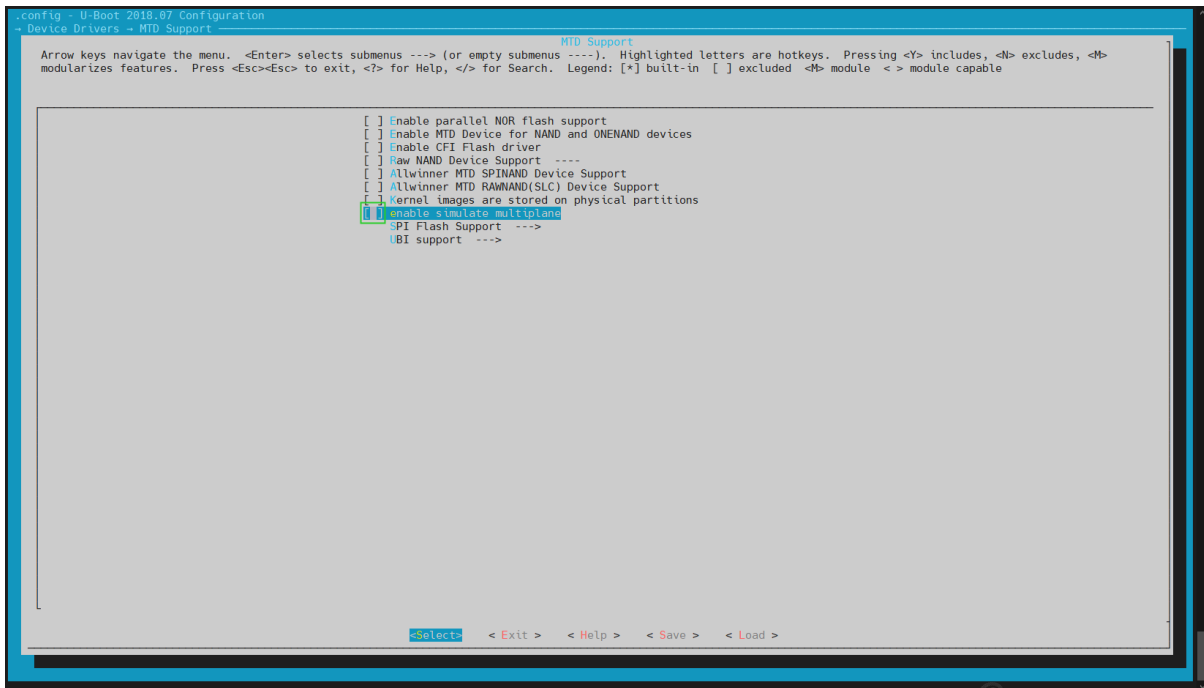


图 4-2: defconfig_nand_single_plane

4.1.2 uboot-2023

首先要打开 AW_SPI 和 SPI_MEM 配置

```
Allwinner uboot BSP ----> Device Drivers ---->
[*] SUNXI SPI driver
```

```
Device Drivers ---->
[*] SPI Support ---->
   [*] SPI memory extension
```

接着打开 uboot-bsp 仓库中的 spinand 配置

```
Allwinner uboot BSP ----> Device Drivers ---->
[*] SUNXI awnand driver
[*] Allwinner MTD SPINAND Device Support
```

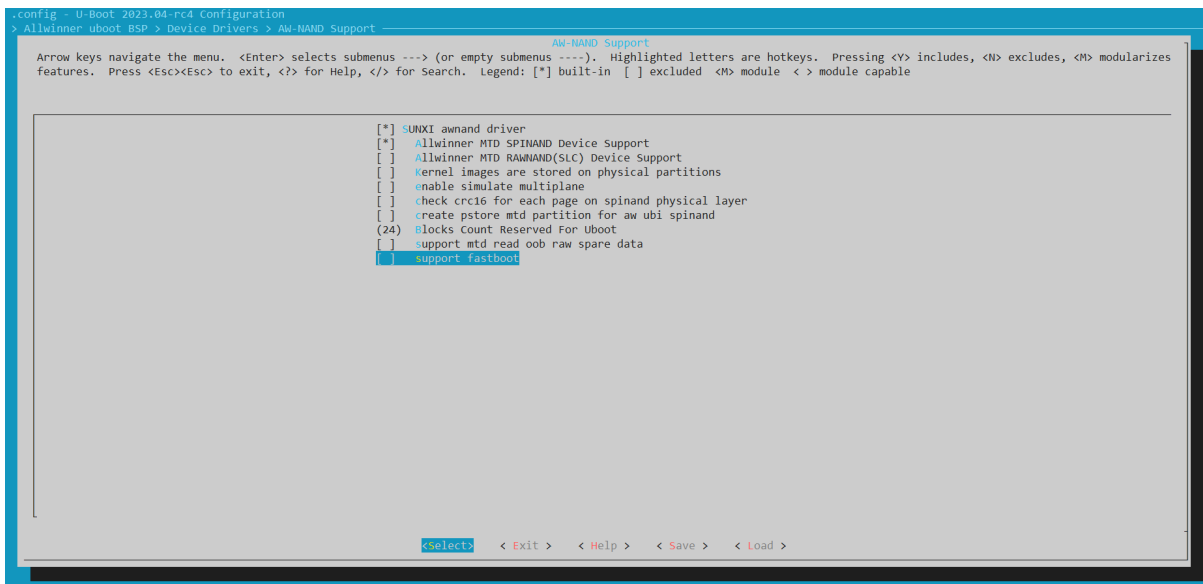


图 4-3: uboot2023_support_spinand

如果内核是 Linux5.10 或 Linux 5.15, 则应配置成 Single Plane (不打开 enable simulate multiplane, 之前的内核版本则需要打开), 如下所示:

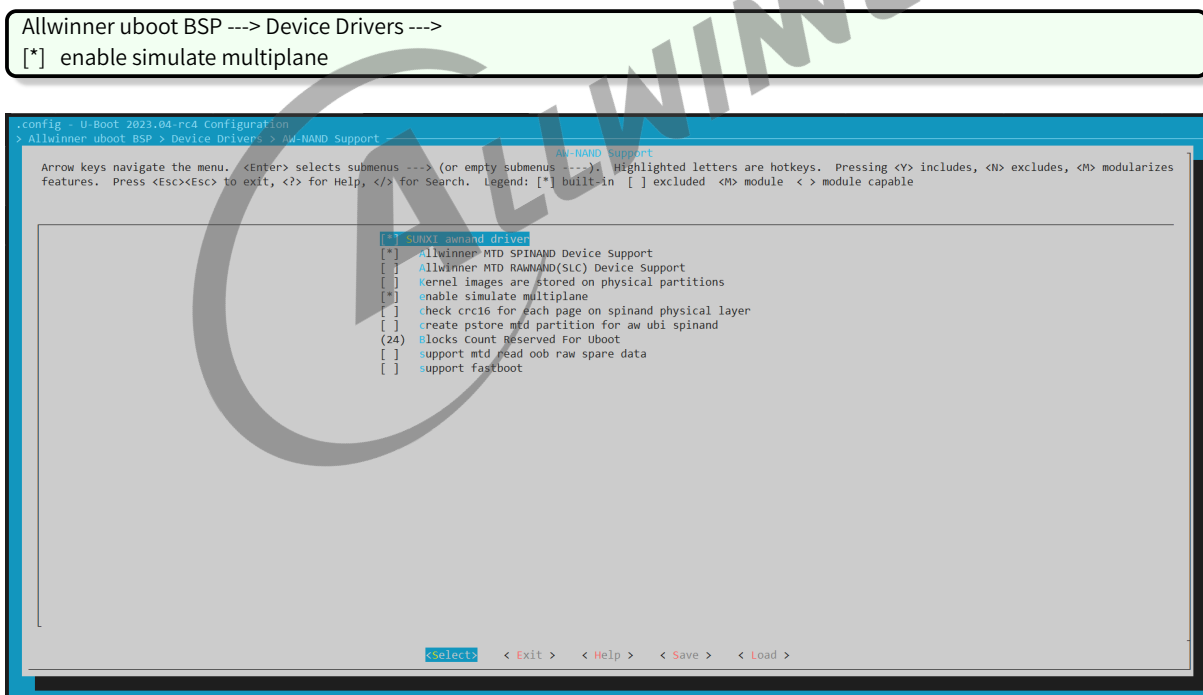


图 4-4: uboot2023_spinand_twoplane

4.2 kernel 模块配置

4.2.1 Linux4.9

Device Drivers->Memory Technology Device (AW_MTD) support

<*> Allwinner MTD SPINAND Device Support

-* Enable UBI - Unsorted block images --->

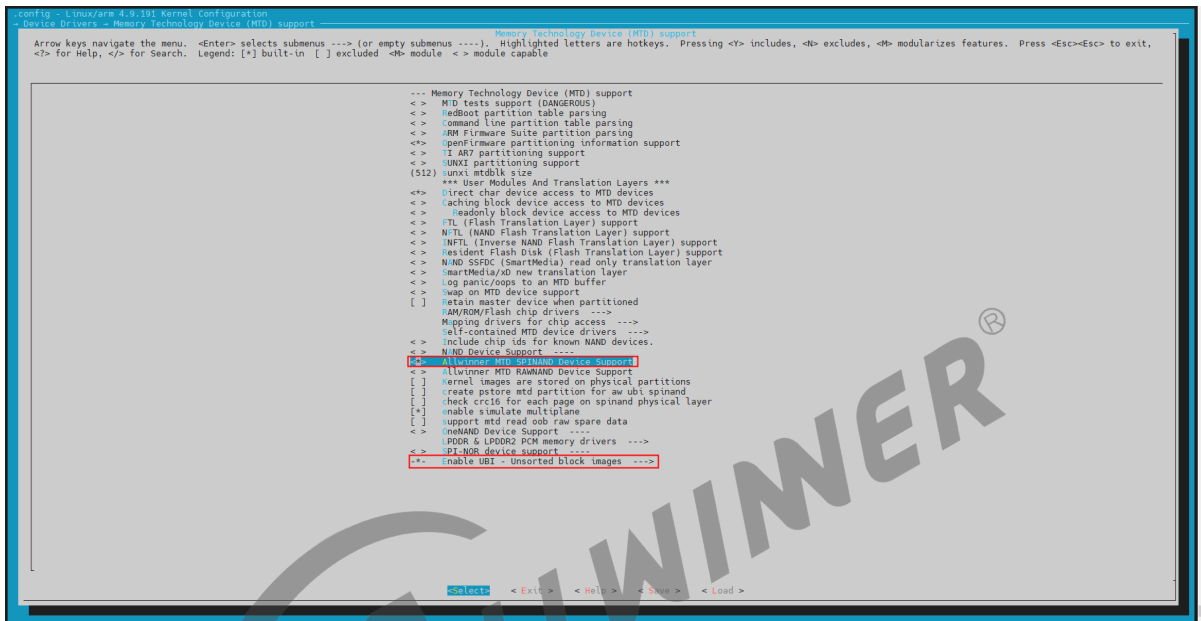


图 4-5: MTD_SPINAND_UBI

File systems->Miscellaneous filesystems->

<*> UBIFS file system support

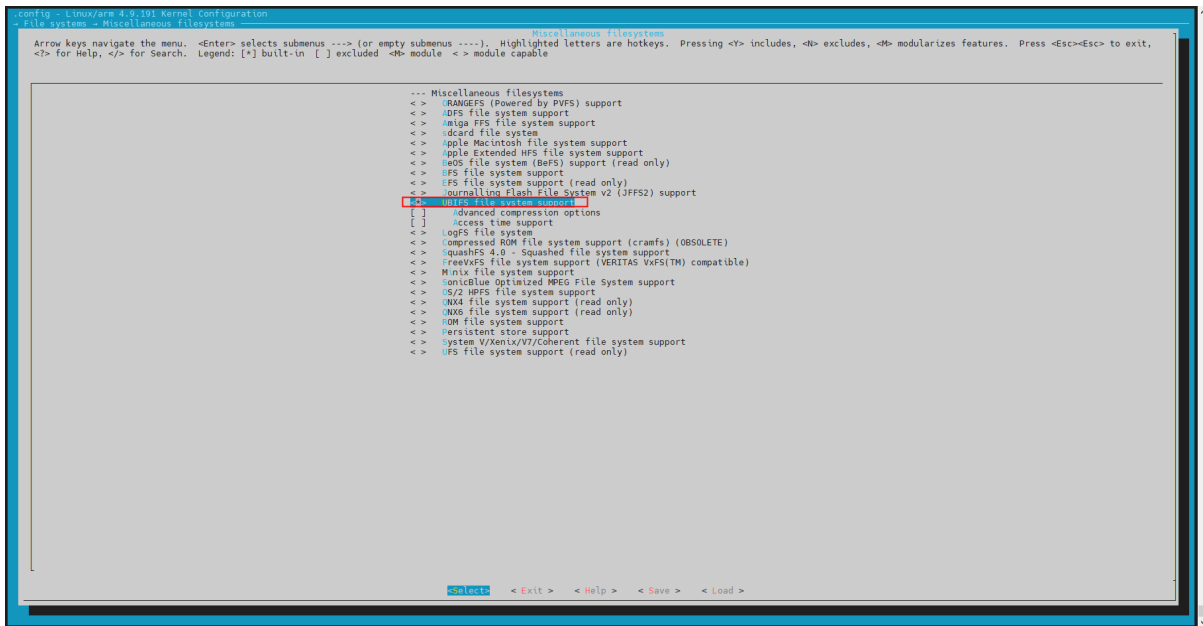


图 4-6: UBIFS

4.2.2 Linux5.4

Device Drivers->Memory Technology Device (AW_MTD) support
 sunxi-nand --->
 <*> Awnand Choice (Allwinner MTD SPINAND Device Support) --->
 (X) Allwinner MTD SPINAND Device Support
 () Allwinner MTD RAWNAND Device Support
 -* Enable UBI - Unsorted block images --->

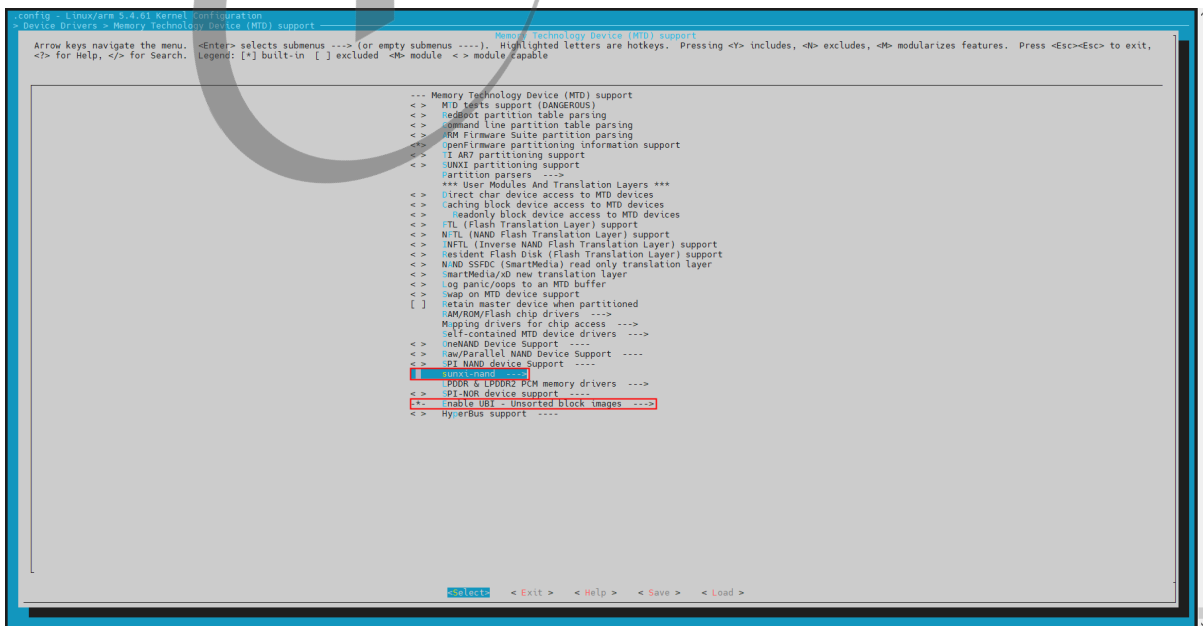


图 4-7: sunxi-nand_UBI

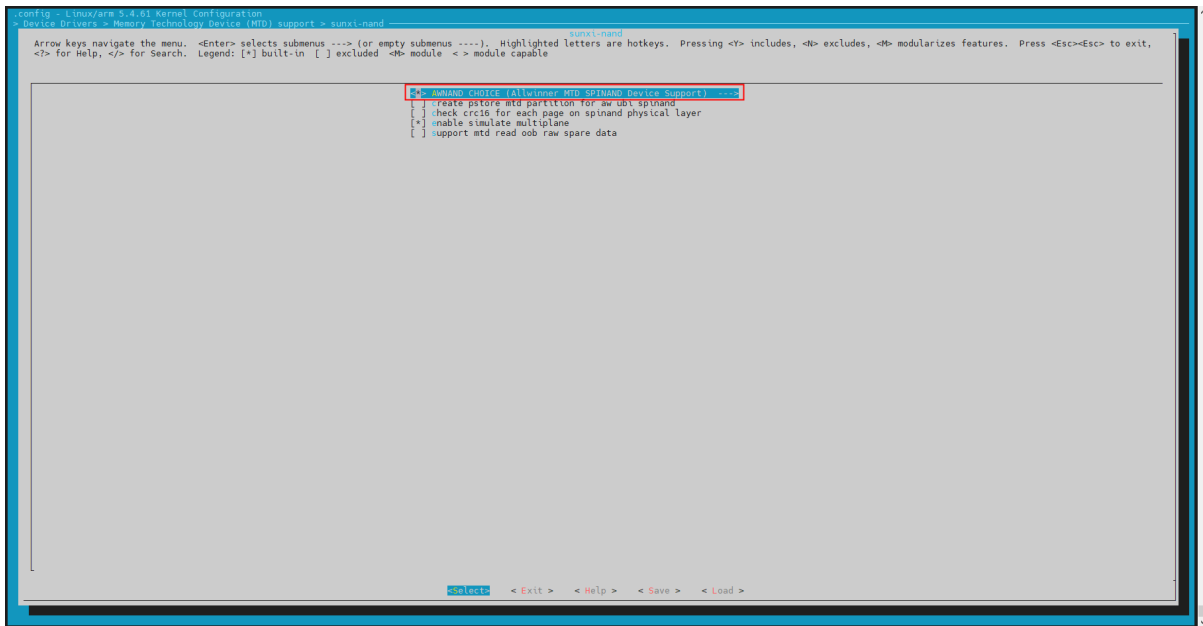


图 4-8: AWNAND_CHOICE

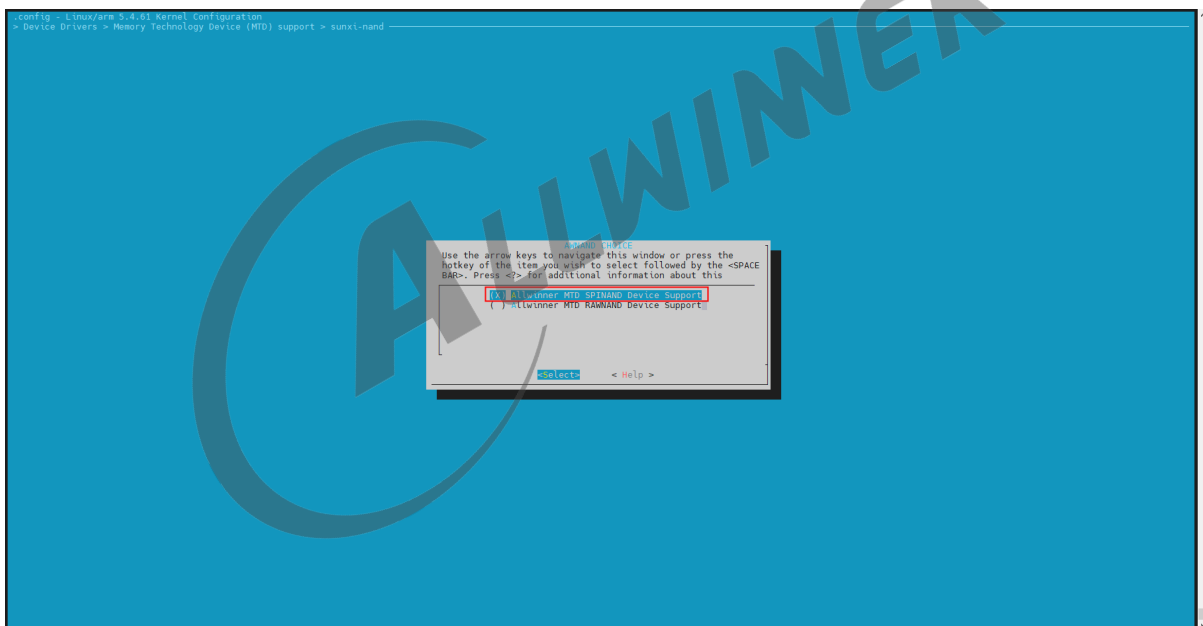


图 4-9: SPINAND_Support

Device Drivers->SPI support
 [*] SPI support --->
 <*> SUNXI SPI Controller

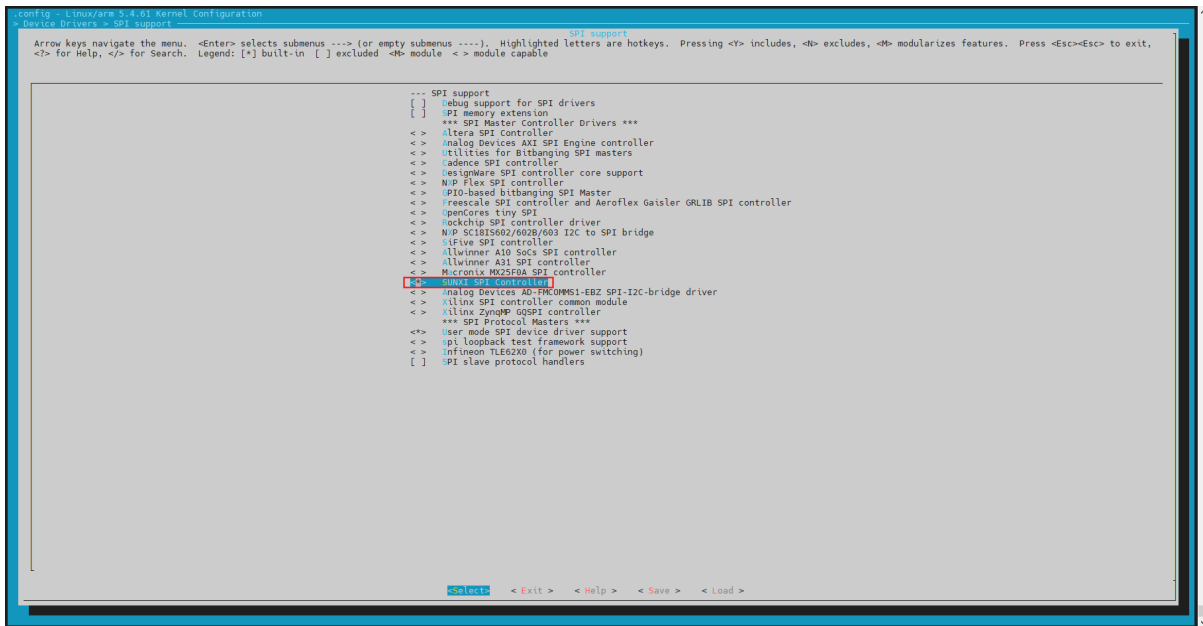


图 4-10: SUNXI_SPI_Controller

Device Drivers->DMA Engine support
 [*] DMA Engine support --->
 <*> Allwinner A31 SoCs DMA support

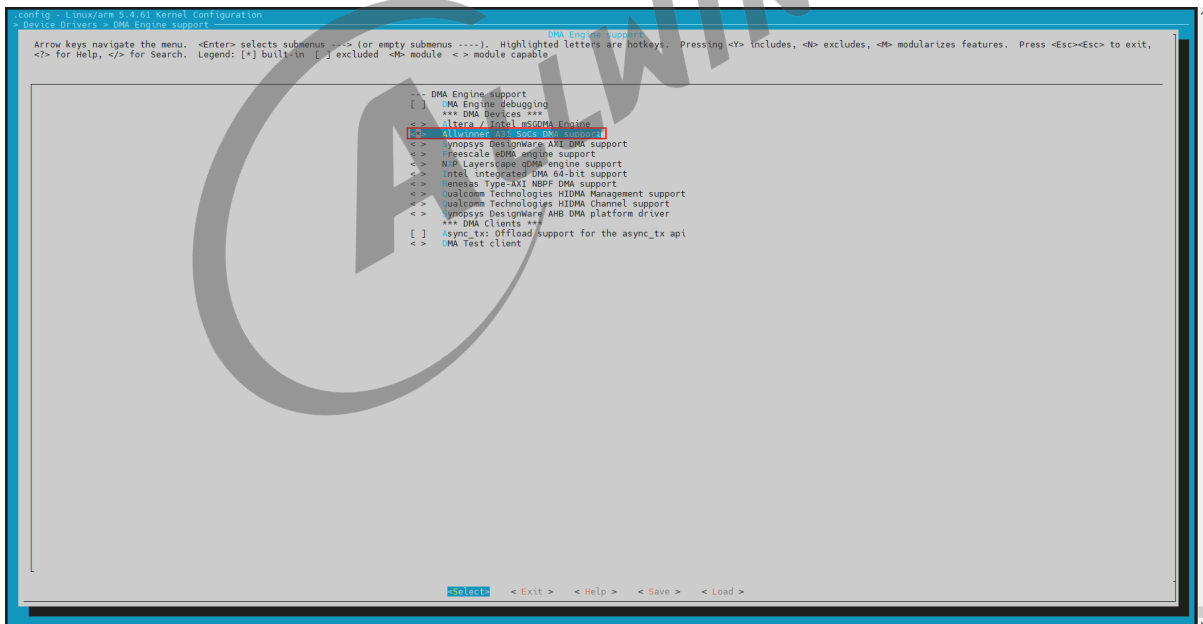


图 4-11: A31_DMA_support

Device Drivers->SOC (System On Chip)
 <*> Allwinner sunxi sid support

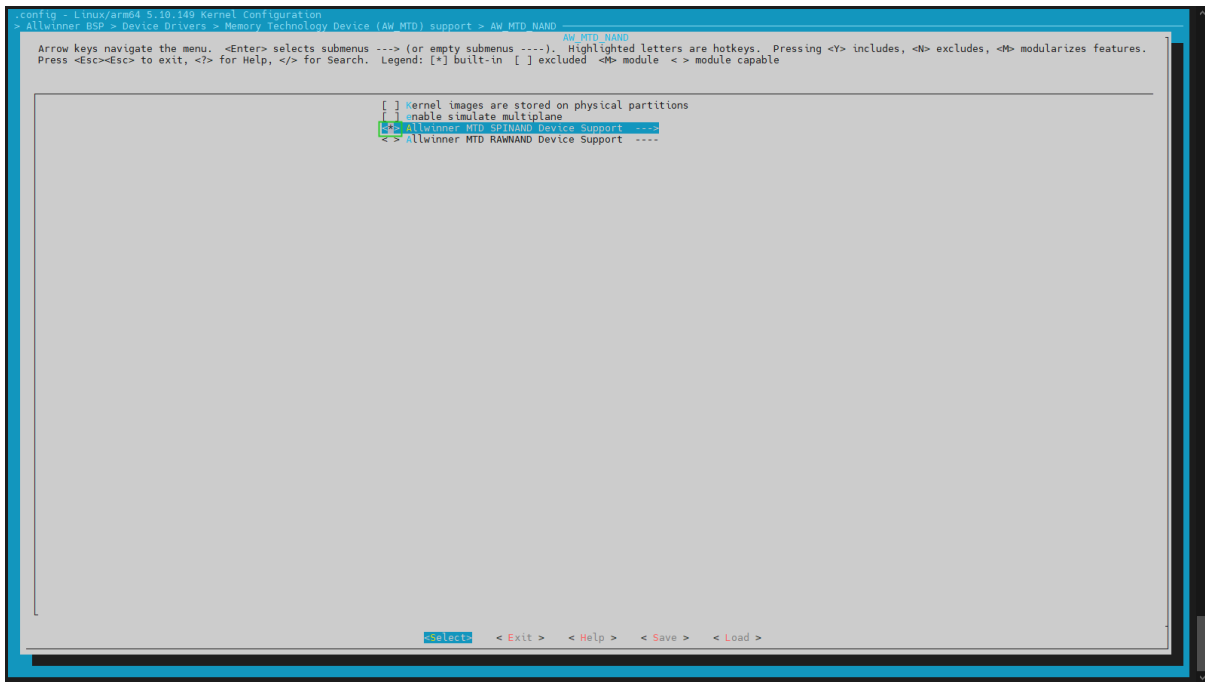


图 4-14: menuconfig_bsp_MTD

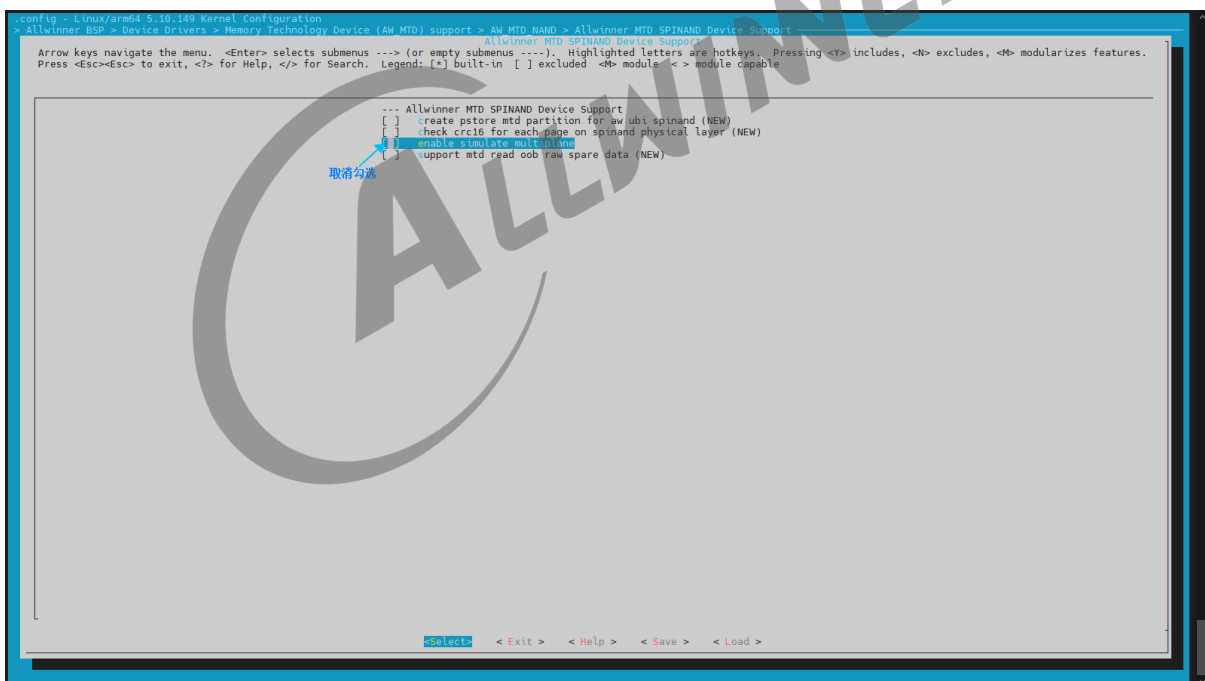


图 4-15: menuconfig_bsp_single_plane

Allwinner BSP->Device Drivers->SPI Drivers
 <> SPI Support for Allwinner SoCs

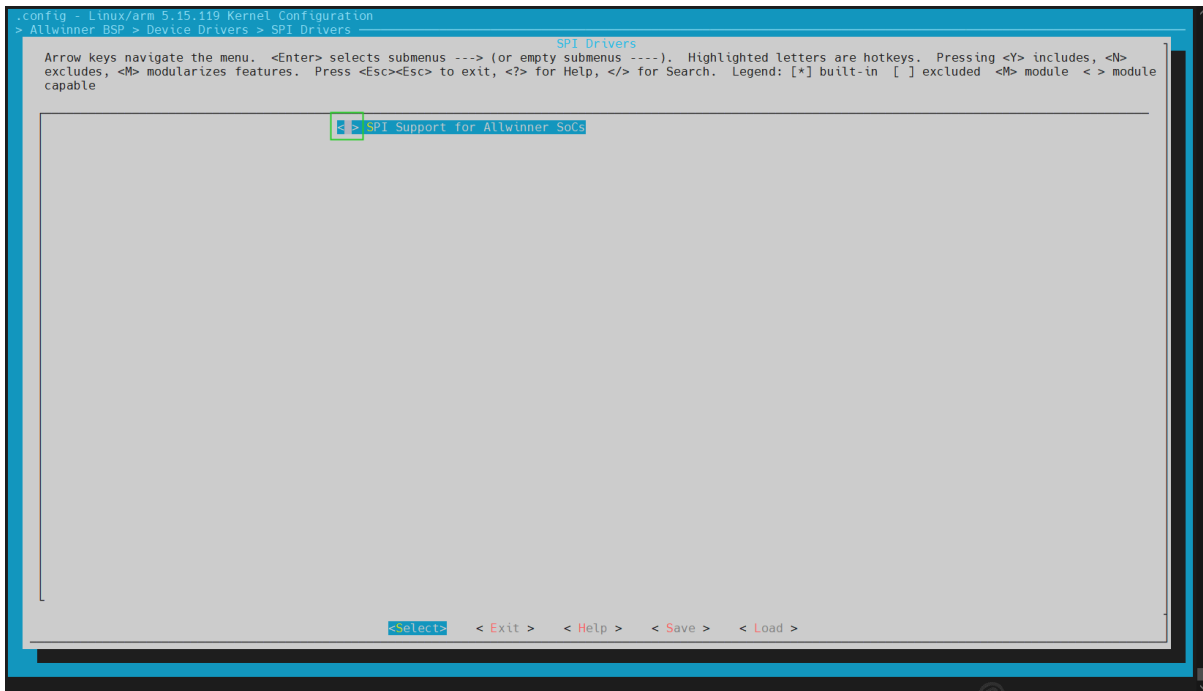


图 4-16: SPI_Support

Allwinner BSP > Device Drivers > SPI NG Drivers
 <*> SPI NG Driver Support for Allwinner SoCs

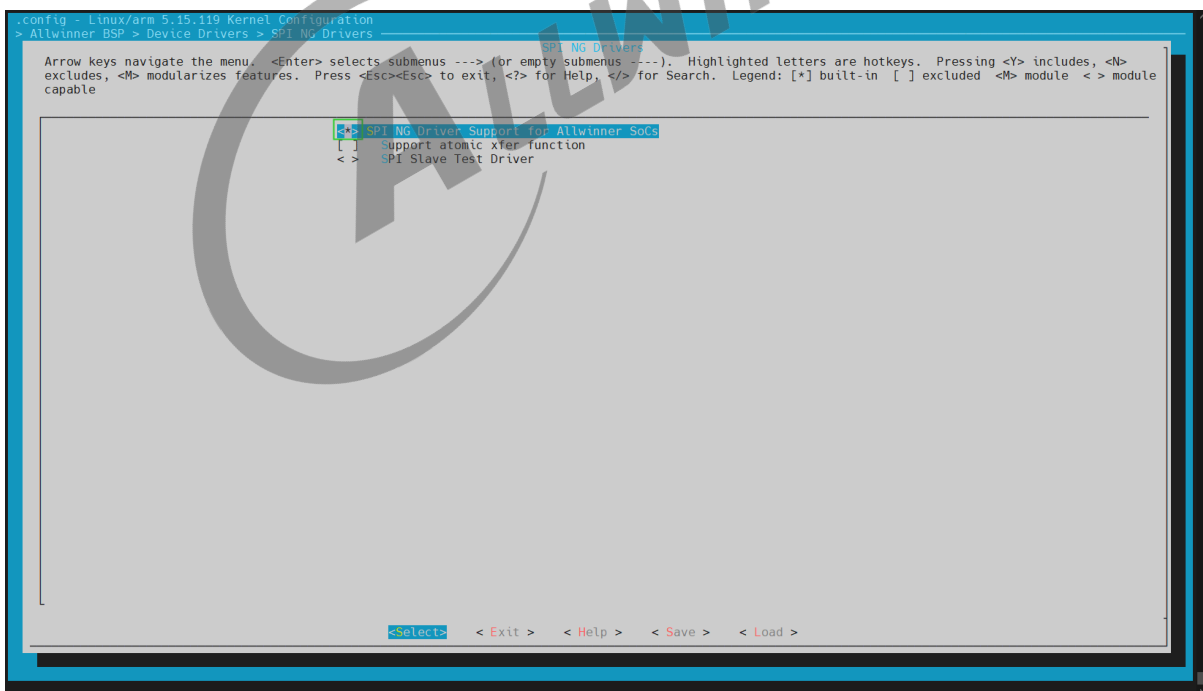


图 4-17: SPI_Support

Allwinner BSP->Device Drivers->DMA Drivers
 <*> DMA Support for Allwinner SoCs

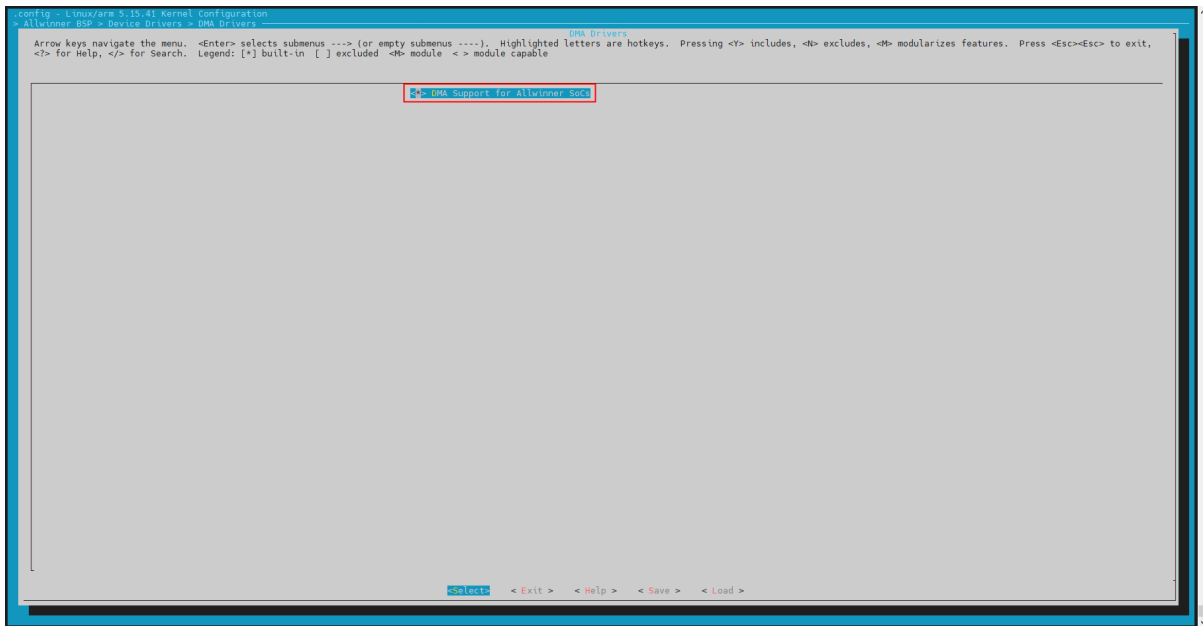


图 4-18: DMA_Support

Device Drivers -> Memory Technology Device (MTD) support
 <*> Caching block device access to MTD devices

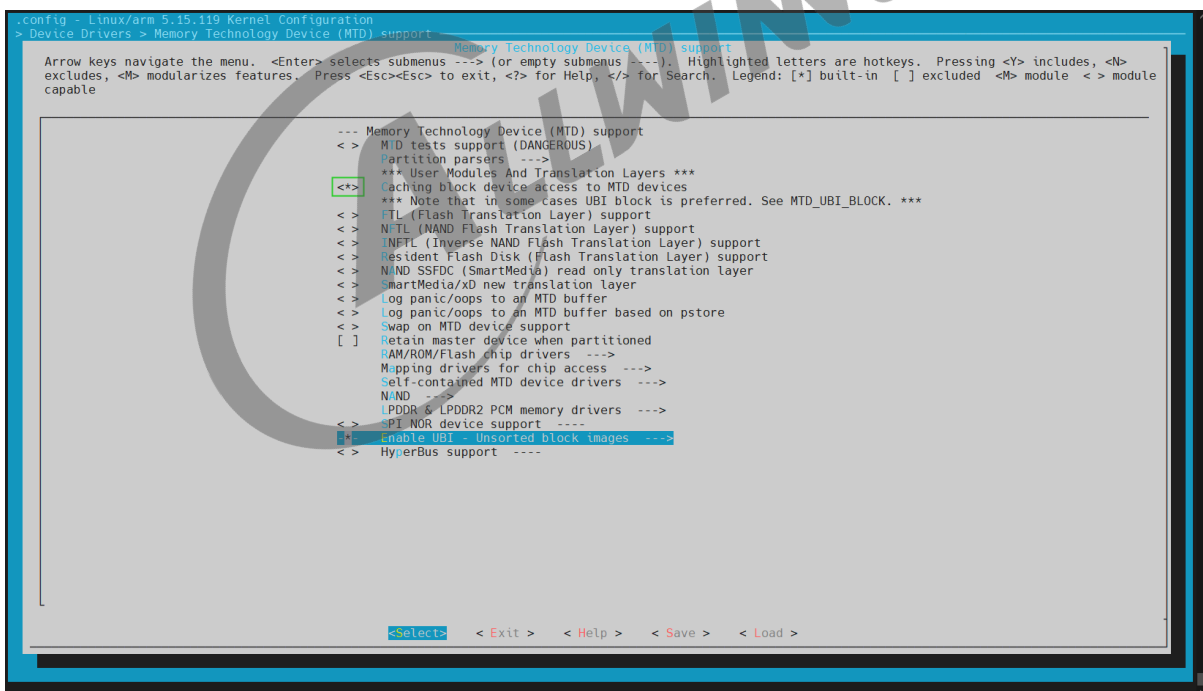


图 4-19: menuconfig_MTD

Device Drivers -> Memory Technology Device (MTD) support -> Enable UBI
 <*> MTD devices emulation driver (gluebi)

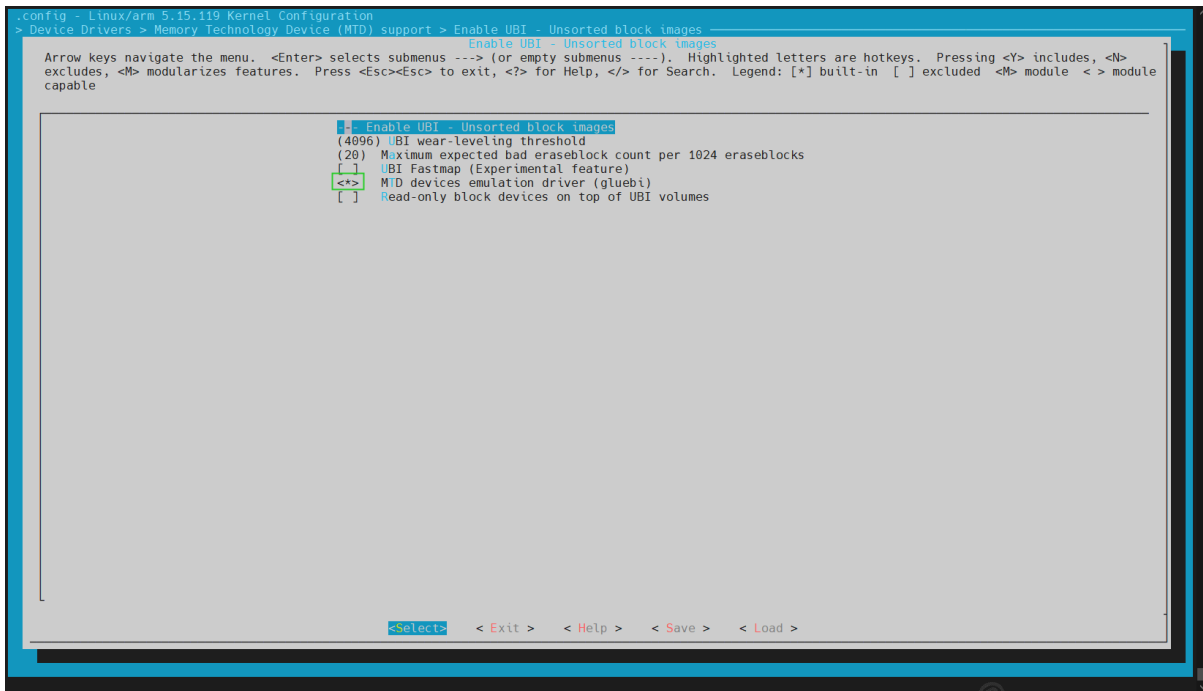


图 4-20: menuconfig_UBI

File systems->Miscellaneous filesystems

<+> UBIFS file system support

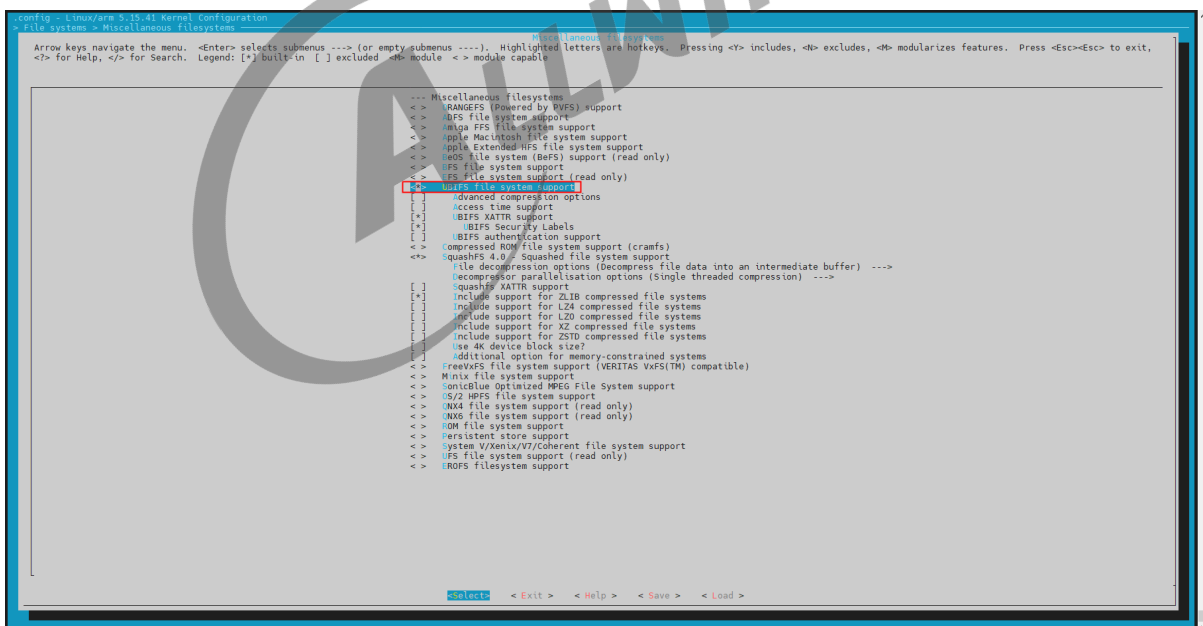


图 4-21: UBIFS_Support

General setup

[] Initial RAM filesystem and RAM disk (initramfs/initrd) support

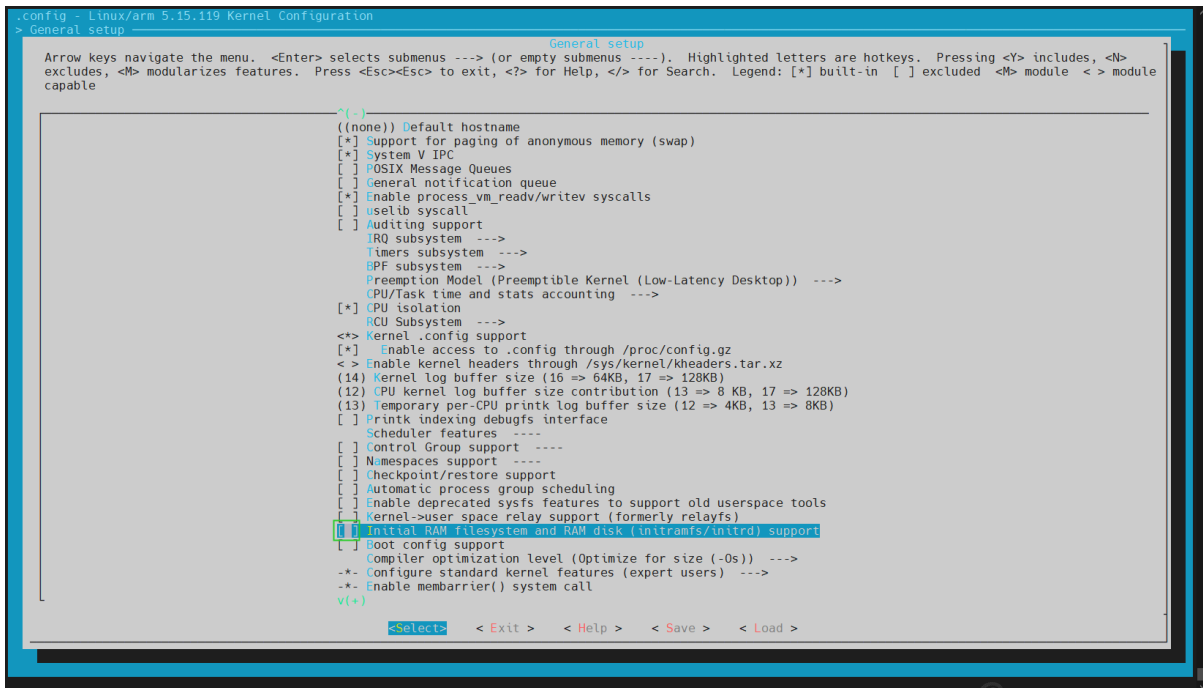


图 4-22: menuconfig_general_setup_ram

4.2.4 env.cfg

在 env.cfg 中添加修改下值，setargs_nand_ubi 先 copy 一份 setargs_nand 再添加对应变量的路径：device/config/chips/平台 (T113-i) /configs/evb1_auto_nand/bsp/env.cfg

```

nand_root=ubi0_4 #这里指定rootfs所对应的ubi卷号，卷号由rootfs分区在sys_partition.fex中的位置确定，mbr为ubi0_0，
                以此类推计算rootfs卷号
mtd_name=sys
rootfstype=ubifs,rw
setargs_nand_ubi=setenv bootargs ubi.mtd=${mtd_name} rootfstype=${rootfstype}
  
```

5 关键数据定义与接口说明

5.1 关键数据定义

5.1.1 flash 设备信息数据结构

```
struct aw_spinand_phy_info {
    const char *Model;
    unsigned char NandID[MAX_ID_LEN];
    unsigned int DieCntPerChip;
    unsigned int BlkCntPerDie;
    unsigned int PageCntPerBlk;
    unsigned int SectCntPerPage;
    unsigned int OobSizePerPage;
#define BAD_BLK_FLAG_MARK      0x03
#define BAD_BLK_FLAG_FRIST_1_PAGE  0x00
#define BAD_BLK_FLAG_FIRST_2_PAGE  0x01
#define BAD_BLK_FLAG_LAST_1_PAGE   0x02
#define BAD_BLK_FLAG_LAST_2_PAGE   0x03
    int BadBlockFlag;
#define SPINAND_DUAL_READ      BIT(0)
#define SPINAND_QUAD_READ     BIT(1)
#define SPINAND_QUAD_PROGRAM  BIT(2)
#define SPINAND_QUAD_NO_NEED_ENABLE BIT(3)
#define SPINAND_ONEDUMMY_AFTER_RANDOMREAD BIT(8)
    int OperationOpt;
    int MaxEraseTimes;
#define HAS_EXT_ECC_SE01      BIT(0)
#define HAS_EXT_ECC_STATUS   BIT(1)
    enum ecc_status_shift ecc_status_shift;
    int EccFlag;
    enum ecc_limit_err EccType;
    enum ecc_oob_protected EccProtectedType;
};
```

说明：

- Model: flash 的 model 名字
- NandID: flash 的 id 码
- DieCntPerChip: 每 chip 的 die 个数
- BlkCntPerDie: 每 die 有多少个 block
- PageCntPerBlk: 每 block 有多少个 page
- SectCntPerPage: 每 page 有多少个扇区
- OobSizePerPage: 每 page 的 oob 大小
- BadBlockFlag: 坏块标志存放在每个 block 的那个 page 中

1. BAD_BLK_FLAG_FRIST_1_PAGE
2. BAD_BLK_FLAG_FIRST_2_PAGE
3. BAD_BLK_FLAG_LAST_1_PAGE
4. BAD_BLK_FLAG_LAST_2_PAGE

- OperationOpt: 支持的操作

1. SPINAND_DUAL_READ
2. SPINAND_QUAD_READ
3. SPINAND_QUAD_PROGRAM
4. SPINAND_QUAD_NO_NEED_ENABLE
5. SPINAND_ONEDUMMY_AFTER_RANDOMREAD

- MaxEraseTimes: 最大擦除数据
- EccFlag: 特性物料读 ecc status 所需 EccFlag 不同
- GD5F1GQ4UCYIG 通过 0Fh + C0h 获取 ecc status, 则无需配置 EccFlag
- MX35LF1GE4AB 通过 7Ch + one dummy byte 获取 ecc status, 则配置 EccFlag = HAS_EXT_ECC_STATUS
- EccType: 设置 ecc 值对应的状态关系
- EccProtectedType: 在 spare 去选择受 ecc 保护的 16byte 作为 oob 区

例 (MX35LF2GE4AD) :

```
{
    .Model      = "MX35LF2GE4AD",
    .NandID     = {0xc2, 0x26, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff},
    .DieCntPerChip = 1,
    .SectCntPerPage = 4,
    .PageCntPerBlk = 64,
    .BlkCntPerDie = 2048,
    .OobSizePerPage = 64,
    .OperationOpt = SPINAND_QUAD_READ | SPINAND_QUAD_PROGRAM |
        SPINAND_DUAL_READ,
    .MaxEraseTimes = 65000,
    .EccFlag      = HAS_EXT_ECC_STATUS,
    .EccType      = BIT4_LIMIT5_TO_8_ERR9_TO_15,
    .EccProtectedType = SIZE16_OFF4_LEN4_OFF8,
    .BadBlockFlag = BAD_BLK_FLAG_FIRST_2_PAGE,
},
```

5.1.2 flash chip 数据结构

```
struct aw_spinand_chip {
    struct aw_spinand_chip_ops *ops;
    struct aw_spinand_ecc *ecc;
    struct aw_spinand_cache *cache;
    struct aw_spinand_info *info;
};
```

```
struct aw_spinand_bbt *bbt;
struct spi_device *spi;
unsigned int rx_bit;
unsigned int tx_bit;
unsigned int freq;
void *priv;
};
```

此结构定义了 flash chip 层的物理模型数据结构以及 chip 层对 flash 的操作接口。

- aw_spinand_chip_ops: flash 读、写、擦等操作接口
- aw_spinand_ecc: flash ecc 读、写和校验操作接口
- aw_spinand_cache: 对缓存 page 的管理，提高读写效率
- aw_spinand_info: flash ID、page size 等信息及获取信息的操作接口
- aw_spinand_bbt: flash 坏块表及管理等操作接口
- spi_device: spi 父设备的操作结构体
- rx_bit: 读状态操作标志
- tx_bit: 写状态操作标志

5.1.3 aw_spinand_chip_request

```
struct aw_spinand_chip_request {
    unsigned int block;
    unsigned int page;
    unsigned int pageoff;
    unsigned int ooblen;
    unsigned int datalen;
    void *databuf;
    void *oobbuf;

    unsigned int oobleft;
    unsigned int dataleft;
};
```

操作目标结构体，改结构体填充我们待操作的 block 的那个 page 的多少偏移的数据 databuf/oobbuf

- block: 待操作块
- page: 待操作页
- pageoff: 操作偏移
- ooblen: 操作 oob 长度
- datalen: 操作数据长度
- databuf: 操作目标数据
- oobbuf: 操作目标 oob

5.1.4 ubi_ec_hdr

```

struct ubi_ec_hdr {
    __be32 magic;
    __u8 version;
    __u8 padding1[3];
    __be64 ec; /* Warning: the current limit is 31-bit anyway! */
    __be32 vid_hdr_offset;
    __be32 data_offset;
    __be32 image_seq;
    __u8 padding2[32];
    __be32 hdr_crc;
} __packed;

```

@magic: erase counter header magic number (%UBI_EC_HDR_MAGIC)

@version: version of UBI implementation which is supposed to accept this UBI image

@padding1: reserved for future, zeroes

@ec: the erase counter

@vid_hdr_offset: where the VID header starts

@data_offset: where the user data start

@image_seq: image sequence number

@padding2: reserved for future, zeroes

@hdr_crc: erase counter header CRC checksum

EC: Erase Count, 记录块的擦除次数, 在 ubiattach 的时候指定一个 mtd, 如果 PEB 上没有 EC, 则用平均的 EC 值, 写入 EC 值只有在擦除的时候才会增加 1

5.1.5 ubi_vid_hdr

```

struct ubi_vid_hdr {
    __be32 magic;
    __u8 version;
    __u8 vol_type;
    __u8 copy_flag;
    __u8 compat;
    __be32 vol_id;
    __be32 lnum;
    __u8 padding1[4];
    __be32 data_size;
    __be32 used_ebs;
    __be32 data_pad;
    __be32 data_crc;
    __u8 padding2[4];
    __be64 sqnum;
}

```

```

__u8 padding3[12];
__be32 hdr_crc;
}__packed;

```

@magic: volume identifier header magic number (%UBI_VID_HDR_MAGIC)

@version: UBI implementation version which is supposed to accept this UBI image (%UBI_VERSION)

@vol_type: volume type (%UBI_VID_DYNAMIC or %UBI_VID_STATIC)

@copy_flag: if this logical eraseblock was copied from another physical eraseblock (for wear-leveling reasons)

@compat: compatibility of this volume(%0, %UBI_COMPAT_DELETE, %UBI_COMPAT_IGNORE, %UBI_COMPAT_PRESERVE, or %UBI_COMPAT_REJECT)

@vol_id: ID of this volume

@lnum: logical eraseblock number

@padding1: reserved for future, zeroes

@data_size: how many bytes of data this logical eraseblock contains

@used_ebs: total number of used logical eraseblocks in this volume

@data_pad: how many bytes at the end of this physical eraseblock are not used

@data_crc: CRC checksum of the data stored in this logical eraseblock

@padding2: reserved for future, zeroes

@sqnum: sequence number

@padding3: reserved for future, zeroes

@hdr_crc: volume identifier header CRC checksum

参数说明

@sqnum 是创建此 VID 头时的全局序列计数器的值。每次 UBI 写一个新的 VID 头到 flash 时，全局序列计数器都会增加，比如当它将一个逻辑的 eraseblock 映射到一个新的物理的 eraseblock 时。全局序列计数器是一个无符号 64 位整数，我们假设它永远不会溢出。@sqnum(序列号) 用于区分新旧版本的逻辑擦除块。

有两种情况，可能有多个物理 eraseblock 对应同一个逻辑 eraseblock，即在卷标识头中有相同的 **@vol_id** 和 **@lnum** 值。假设我们有一个逻辑的擦除块 L，它被映射到物理的擦除块 P。

1. 因为 UBI 可以异步擦除物理上的擦除块，所以可能出现以下情况:L 被异步擦除，所以 P 被安排擦除，然后 L 被写入，即。映射到另一个物理的擦除块 P1，所以 P1 被写入，然后不干净的重

启发生。结果-有两个物理的 eraseblock P 和 P1 对应同一个逻辑的 eraseblock L。但是 P1 的序列号更大，所以 UBI 在连接 flash 时选择 P1。

2. UBI 不时地将逻辑擦除块移动到其它物理擦除块，以达到损耗均衡的目的。例如，如果 UBI 将 L 从 P 移动到 P1，在 P 被物理擦除之前会发生不干净的重启，有两个物理擦除块 P 和 P1 对应于 L，UBI 必须在 flash 连接时选择其中一个。**@sqnum** 字段表示哪个 PEB 是原始的（显然 P 的 **@sqnum** 更低）和副本。但是选择具有更高序列号的物理擦除块是不够的，因为不干净的重启可能发生在复制过程的中间，因此 P 中的数据被损坏（P->P1 没复制完）。仅仅选择序号较低的物理擦除块是不够的，因为那里的数据可能很旧（考虑在复制之后向 P1 添加更多数据的情况）。此外，不干净的重启可能发生在擦除 P 刚刚开始的时候，所以它会导致不稳定的 P，“大部分”是 OK 的，但仍然有不稳定的情况。

UBI 使用 **@copy_flag** 字段表示这个逻辑擦除块是一个副本。UBI 还计算数据的 CRC，当数据被移动时，并将其存储在副本 (P1) 的 **@data_crc** 字段。因此，当 UBI 需要从两个 (P 或 P1) 中选择一个物理擦除块时，会检查新块 (P1) 的 **@copy_flag**。如果它被清除，情况就简单了，新的就会被选中。如果设置了该值，则检查副本 (P1) 的数据 CRC。如果 CRC 校验和是正确的，这个物理擦除块被选中 (P1)。否则，将选择较老的 P。

如果是静态卷，**@data_crc** 字段包含逻辑擦除块内容的 CRC 校验和。对于动态卷，它不包含 CRC 校验和规则。唯一的例外情况是，当物理擦除块的数据被磨损均衡子系统移动时，磨损均衡子系统计算数据 CRC，并将其存储在 **@data_crc** 字段中。

@used_ebs 字段仅用于静态卷，它表示该卷的数据需要多少个擦除块。对于动态卷，这个字段不被使用并且总是包含 0。

@data_pad 在创建卷时使用对齐参数计算。因此，**@data_pad** 字段有效地减少了该卷的逻辑擦除块的大小。当一个人在 UBI 卷上使用面向块的软件（比如，cramfs）时，这是非常方便的。

LEB 与 PEB

MULTIPLANE 方案，data 区域为 504 个扇区，非 MULTIPLANE 方案，data 区域为 248 个扇区

block size = 128k 为例

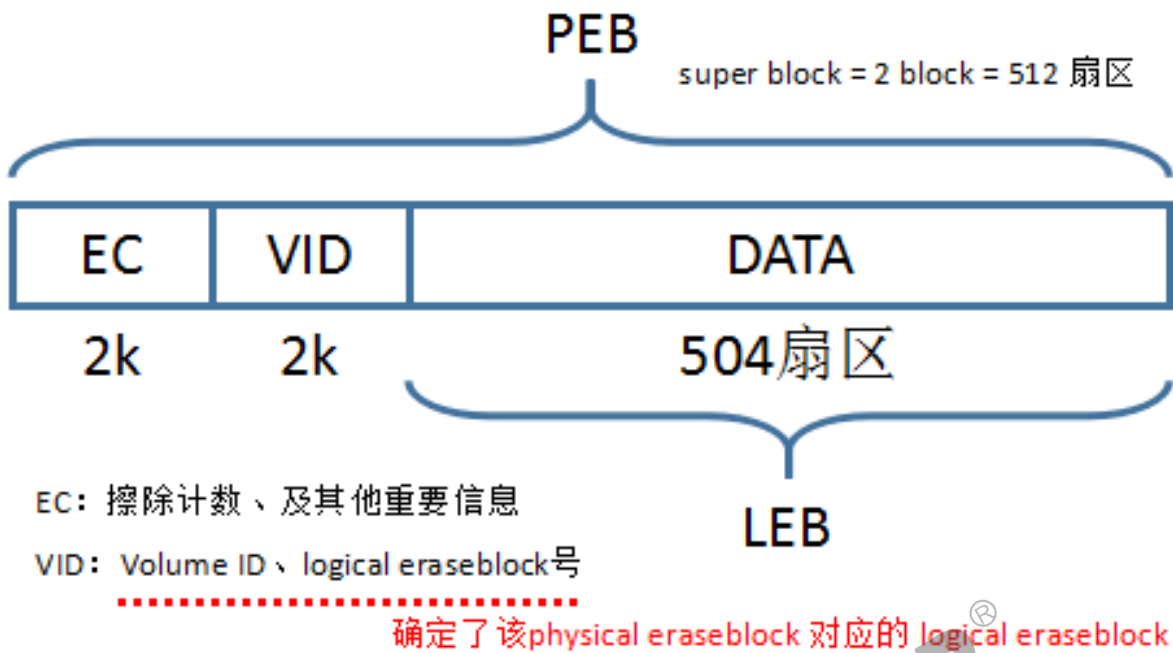


图 5-1: PEB-LEB

5.2 关键接口说明

5.2.1 MTD 层接口

5.2.1.1 aw_spinand_erase

```
static int aw_spinand_erase(struct mtd_info *mtd, struct erase_info *instr)
```

description: mtd erase interface

@mtd: MTD device structure

@instr: erase operation description structure

return: success return 0, fail return fail code

5.2.1.2 aw_spinand_read

```
static int aw_spinand_read(struct mtd_info *mtd, loff_t from, size_t len, size_t *retlen, u_char *buf)
```

description: mtd read interface

@mtd: MTD device structure

@from: offset to read from MTD device

@len: data len

@retlen: had read data len

@buf: data buffer

return: success return max_bitflips, fail return fail code

5.2.1.3 aw_spinand_read_oob

```
static int aw_spinand_read_oob(struct mtd_info *mtd, loff_t from, struct mtd_oob_ops *ops)
```

description: mtd read data with oob

@mtd: MTD device structure

@ops: oob operation description structure

return: success return max_bitflips, fail return fail code

5.2.1.4 aw_spinand_write

```
static int aw_spinand_write(struct mtd_info *mtd, loff_t to, size_t len, size_t *retlen, const u_char *buf)
```

description: mtd write data interface

@to: offset to MTD device

@len: want write data len

@retlen: return the written len

@buf: data buffer

return: success return 0, fail return code fail

5.2.1.5 aw_spinand_write_oob

```
static int aw_spinand_write_oob(struct mtd_info *mtd, loff_t to, struct mtd_oob_ops *ops)
```

description: write data with oob

@mtd: MTD device structure

@to: offset to MTD device

@ops: oob operation description structure

return: success return 0, fail return code fail

5.2.1.6 aw_spinand_block_isbad

```
static int aw_spinand_block_isbad(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs)
```

description: check block is badblock or not

@mtd: MTD device structure

@ofs: offset the mtd device start (align to simu block size)

return: true if the block is bad, or false if the block is good

5.2.1.7 aw_spinand_block_markbad

```
static int aw_spinand_block_markbad(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs)
```

description: mark block at the given offset as bad block

@mtd: MTD device structure

@ofs: offset the mtd device start

return: success to mark return 0, or fail return fail code.

5.2.2 物理层接口

5.2.2.1 aw_spinand_chip_read_single_page

```
static int aw_spinand_chip_read_single_page(struct aw_spinand_chip *chip,  
struct aw_spinand_chip_request *req)
```

description: Read physics on a page

@chip: See 3.3.2

@req: See 3.3.3

return: zero on success, else a negative error code.

5.2.2.2 aw_spinand_chip_write_single_page

```
static int aw_spinand_chip_write_single_page(struct aw_spinand_chip *chip,  
                                             struct aw_spinand_chip_request *req)
```

description: Write physics on a page

@chip: See 3.3.2

@req: See 3.3.3

return: zero on success, else a negative error code.

5.2.2.3 aw_spinand_chip_erase_single_block

```
static int aw_spinand_chip_erase_single_block(struct aw_spinand_chip *chip,  
                                             struct aw_spinand_chip_request *req)
```

description: Erase physics on a block

@chip: See 3.3.2

@req: See 3.3.3

return: zero on success, else a negative error code.

5.2.2.4 aw_spinand_chip_isbad_single_block

```
static int aw_spinand_chip_isbad_single_block(struct aw_spinand_chip *chip,  
                                             struct aw_spinand_chip_request *req)
```

description: Set to bad block

@chip: See 3.3.2

@req: See 3.3.3

return: zero on success, else a negative error code.

5.2.2.5 aw_spinand_chip_markbad_single_block

```
static int aw_spinand_chip_markbad_single_block(struct aw_spinand_chip *chip,  
struct aw_spinand_chip_request *req)
```

description: Set to bad block

@chip: See 3.3.2

@req: See 3.3.3

return: zero on success, else a negative error code.

5.2.3 Uboot 应用接口

5.2.3.1 sunxi_flash_nand_probe

```
static int sunxi_flash_nand_probe(void)
```

description: MTD layer and SPINAND || RAWNAND initialization, Set the storage type.

return: zero on success, else a negative error code.

5.2.3.2 sunxi_flash_nand_init

```
static int sunxi_flash_nand_init(int boot_mode, int res)
```

description: MTD layer and SPINAND || RAWNAND initialization.

boot_mode: Working mode

res: The default is 0

return: zero on success, else a negative error code.

5.2.3.3 sunxi_flash_nand_exit

```
int spinand_mtd_exit(void)
```

description: Release registration is a resource for applications.

return: zero on success, else a negative error code.

5.2.3.4 sunxi_flash_nand_write

```
static int sunxi_flash_nand_write(uint start_block, uint nblock, void *buffer)
```

description: mtd write data interface.

start_block: want write start block

nblock: want write block count

buffer: data buffer

return: zero on success, else a negative error code.

5.2.3.5 sunxi_flash_nand_read

```
static int sunxi_flash_nand_read(uint start_block, uint nblock, void *buffer)
```

description: mtd readdata interface.

start_block: want read start block

nblock: want read block count

buffer: data buffer

return: zero on success, else a negative error code.

5.2.3.6 sunxi_flash_nand_erase

```
static int sunxi_flash_nand_erase(int erase, void *mbr_buffer)
```

description: erase boot || partition data.

erase: erase flag

buffer: The default is NULL

return: zero on success, else a negative error code.

5.2.3.7 sunxi_flash_nand_force_erase

```
int spinand_mtd_force_erase(void)
```

description: erase boot & partition data.

return: zero on success, else a negative error code.

5.2.3.8 sunxi_flash_nand_flush

```
int ubi_nand_flush(void)
```

description: Flush physical cache data to flash.

return: zero on success, else a negative error code.

5.2.3.9 sunxi_flash_nand_download_spl

```
static int sunxi_flash_nand_download_spl(unsigned char *buf, int len, unsigned int ext)
```

description: write boot0.

buf: boot0 data buffer

len: boot0 data len

ext: storage type

return: zero on success, else a negative error code.

5.2.3.10 sunxi_flash_nand_download_toc

```
static int sunxi_flash_nand_download_toc(unsigned char *buf, int len, unsigned int ext)
```

description: write uboot.

buf: uboot data buffer

len: uboot data len

ext: storage type

return: zero on success, else a negative error code.

6 功能开发

在 ubi 卷上模拟 mtdblock 设备，挂载块设备文件系统

1. 在 sys_partition*.fex 中添加分区（大小要求对齐到 504 扇区）；
2. 在内核配置中打开 CONFIG_MTD_BLOCK、CONFIG_MTD_UBI_GLUEBI；
3. 编译、打包、烧录固件；
4. 对应的块设备为/dev/mtdblock*，具体序号可以从后往前对应 sys_partition*.fex 文件中的分区
5. 如果 sys_partition*.fex 中没有指定 downloadfile，挂载前需要格式化：mkfs.vfat /dev/mtdblock12
6. 挂载分区：mkdir /mnt/test1 & mount -t vfat /dev/mtd12 /mnt/test1；

6.1 功能概述

主要介绍 boot、内核态、用户态访问 flash 时的流程说明。

6.2 开发流程

6.2.1 BOOT0 读取数据

```
/* 头文件依赖 */
#include <spinand_boot0.h>

__s32 SpiNand_Read(__u32 sector_num, void *buffer, __u32 N)
```

参数说明：

sector_num：起始扇区，一个扇区等于 512byte

buffer：存放数据的缓存

N：要读取的 page 数

6.2.2 uboot shell 使用

mem_addr: 内存地址, 0x40000000 之后可以随便选取如: 0x45000000, 0x46000000

part_name: 分区文件名, boot-resource、env、boot、rootfs

size: 可以省略, 默认读取整个分区文件

1. sunxi_flash read [size] 读取 flash 中的分区文件到内存中

例: 使用 sunxi_flash read 命令将 boot 分区读入到 0x49000000 中, 然后使用 md 命令读取 0x49000000 中的内容。

```
=> sunxi_flash read 0x49000000 boot
partinfo: name boot, start 0x2620, size 0x3c80
=> md 0x49000000
49000000: 52444e41 2144494f 003b52b0 40008000  ANDROID!.R;...@
49000010: 003cfac7 41000000 00000000 40f00000  ..<...A.....@
49000020: 40000100 00000800 00000000 00000000  ...@.....
49000030: 386e7573 72615f69 0000006d 00000000  sun8i_arm.....
49000040: 00000000 00000000 00000000 00000000  .....
49000050: 00000000 00000000 00000000 00000000  .....
```

图 6-1: sunxi flash read

验证方法:

1. 0x49000000 读入前与读入后数据有没有发生变化
2. 在 **out/pack_out** 目录下找到对应的分区文件, 使用 **hexdump -Cv boot.fex -n 500** 命令输出分区文件的数据, 对比一致即读入成功。

```
guanyanfei@AwExdroid100:~/workspace/longanV853/out/pack_out$ hexdump -Cv boot.fex -n 500
00000000 41 4e 44 52 4f 49 44 21 b0 52 3b 00 00 80 00 40 | ANDROID!.R;...@
00000010 c7 fa 3c 00 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 f0 40 | ..<...A.....@
00000020 00 01 00 40 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ...@.....
00000030 73 75 6e 38 69 5f 61 72 6d 00 00 00 00 00 00 00 | sun8i_arm.....
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | .....
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | .....
00000060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | .....
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | .....
```

图 6-2: hexdump

2. sunxi_flash write [size] 将内存中的数据, 写入到分区中

例:

1) 使用 mm 命令修改内存内容

```

46000010: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
=> mm 0x44000000          修改内存中数据
44000000: fedcba98 ? 123
44000004: fedcba99 ? 456
44000008: fedcba9a ? 789
4400000c: fedcba9b ? ?    ? 退出编辑
=> md 0x44000000          查看内存
44000000: 00000123 00000456 00000789 fedcba9b #...V..... 修改后数据
44000010: fedcba9c fedcba9d fedcba9e fedcba9f .....
44000020: fedcbaa0 fedcbaa1 fedcbaa2 fedcbaa3 .....
44000030: fedcbaa4 fedcbaa5 fedcbaa6 fedcbaa7 .....
44000040: fedcbaa8 fedcbaa9 fedcbaaa fedcbab0 .....

```

图 6-3: mm - md

2) 使用 sunxi_flash write 0x44000000 env 将内存中的数据写入 env 分区

```

=> sunxi_flash write 0x44000000 env
guanaynfet.:start: 0x2d00, len: 0x100

```

图 6-4: sunxi flash write

3) 重新将 env 分区读入内存中, 对比一致表示写入成功

```

=> sunxi_flash read 0x45000000 env          读env分区
partinfo: name env, start 0x2520, size 0x100
=> md 45000000          显示内存数据
45000000: 00000123 00000456 00000789 fedcba9b #...V.....
45000010: fedcba9c fedcba9d fedcba9e fedcba9f .....
45000020: fedcbaa0 fedcbaa1 fedcbaa2 fedcbaa3 .....
45000030: fedcbaa4 fedcbaa5 fedcbaa6 fedcbaa7 .....
45000040: fedcbaa8 fedcbaa9 fedcbaaa fedcbab0 .....

```

图 6-5: sunxi flash read2

6.2.3 内核态访问 flash

代码示例

```

/* 头文件依赖 */
#include <linux/fs.h>
#include <linux/uaccess.h>

char part_name = "/dev/ubo0_0";
struct file *fp;
mm_segment_t fs;

fp = filp_open(part_name, O_RDONLY, 0444);
if (IS_ERR(fp)) {
    printk("open %s error\n", part_name);
}

```

```
return -1;
}

fs = get_fs();
set_fs(KERNEL_DS);

ret = vfs_read(fp, buf, len, pos);
ret = vfs_write(fp, buf, len, pos);

filp_close(fp, NULL);
set_fs(fs);
```

下面注意说明一下 `vfs_write` 接口

```
vfs_write(struct file *file, const char __user *buf, size_t count, loff_t *pos)
```

file: 传入 `filp_open` 的返回值

buf: 要写入的数据 `buf`

count: 要写入的数据大小, `byte` 为单位

pos: 要写入的数据偏移, `byte` 为单位

6.2.4 用户态访问 flash

代码示例

```
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <linux/mtd/mtd-user.h>

#define DEVICE "/dev/mtdblock0" // 替换为实际的 mtdblock 设备节点
#define BUFFER_SIZE 4096

int main() {
    int fd;
    char buffer[BUFFER_SIZE];

    // 打开 mtdblock 设备
    fd = open(DEVICE, O_RDWR);
    if (fd < 0) {
        perror("Failed to open mtdblock device");
        return 1;
    }

    // 读取数据
    ssize_t bytes_read = read(fd, buffer, BUFFER_SIZE);
    if (bytes_read < 0) {
        perror("Failed to read from mtdblock device");
        close(fd);
        return 1;
    }
}
```

```
printf("Read %zd bytes from %s\n", bytes_read, DEVICE);

// 打印读取的数据
for (ssize_t i = 0; i < bytes_read; i++) {
    printf("%02x ", (unsigned char)buffer[i]);
}
printf("\n");

// 写入数据
const char *data_to_write = "Hello MTD!";
ssize_t bytes_written = write(fd, data_to_write, strlen(data_to_write));
if (bytes_written < 0) {
    perror("Failed to write to mtblock device");
    close(fd);
    return 1;
}
printf("Wrote %zd bytes to %s\n", bytes_written, DEVICE);

// 关闭设备
close(fd);
return 0;
}
```

参数介绍

- **DEVICE**: 设备节点的路径，例如 /dev/mtdblock0。根据系统中的实际设备进行修改。
- **open()**: 用于打开设备文件。参数 **O_RDWR** 表示以读写方式打开设备。
- **read(fd, buffer, BUFFER_SIZE)**:
- **fd**: open() 返回的文件描述符。
- **buffer**: 存储读取数据的缓冲区。
- **BUFFER_SIZE**: 要读取的字节数。
- **write(fd, data_to_write, strlen(data_to_write))**:
- **fd**: open() 返回的文件描述符。
- **data_to_write**: 要写入的数据。
- **strlen(data_to_write)**: 要写入的字节数。

6.2.5 在 ubi 卷上模拟 mtdblock 设备，挂载块设备文件系统

1. 在 sys_partition*.fex 中添加分区（大小要求对齐到 504 扇区）；
2. 在内核配置中打开 CONFIG_MTD_BLOCK、CONFIG_MTD_UBI_GLUEBI；
3. 编译、打包、烧录固件；
4. 对应的块设备为 /dev/mtdblock*，具体序号可以从后往前对应 sys_partition*.fex 文件中的分区
5. 如果 sys_partition*.fex 中没有指定 downloadfile，挂载前需要格式化：mkfs.vfat /dev/mtdblock12
6. 挂载分区：mkdir /mnt/test1 & mount -t vfat /dev/mtd12 /mnt/test1；

6.3 注意事项

1. **设备节点:** 确保使用正确的设备节点路径，设备节点可能因系统配置而异。
2. **权限:** 确保你有足够的权限访问 `mtdblock` 设备，通常需要 `root` 权限。
3. **数据对齐:** MTD 设备的读写通常需要特定的对齐，具体取决于硬件特性。
4. **数据持久性:** 在写入数据之前，了解设备的擦除块和页面大小，以避免损坏数据。
5. **错误处理:** 在实际应用中，建议在每个系统调用后添加错误处理代码，以处理可能的失败情况。



7 日志分析

```
sunxi:sunxi-spinand:[INFO]: AW SPINand MTD Layer Version: 2.7 20240110
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: AW SPINand Phy Layer Version: 1.13 20231109
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: detect manufacture from id table: GD
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: detect spinand id: fffd1c8 ffffffff
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: ===== arch info =====
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: Model:      GD5F1GQ4UBYIG
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: Manufacture:  GD
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: DieCntPerChip:  1
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: BlkCntPerDie:  1024
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: PageCntPerBlk:  64
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: SectCntPerPage: 4
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: OobSizePerPage: 64
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: BadBlockFlag:  0x0
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: OperationOpt:  0x7
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: MaxEraseTimes: 50000
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: EccFlag:       0x1
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: EccType:       10
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: EccProtectedType: 4
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: =====
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: ===== physical info =====
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: TotalSize: 128 M
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: SectorSize: 512 B
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: PageSize: 2 K
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: BlockSize: 128 K
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: OOBSize: 64 B
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: =====
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: ===== logical info =====
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: TotalSize: 128 M
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: SectorSize: 512 B
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: PageSize: 2 K
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: BlockSize: 128 K
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: OOBSize: 64 B
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: =====
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: block lock register: 0x00
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: feature register: 0x11
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: sunxi physic nand init end
Creating 4 MTD partitions on "nand":
0x000000000000-0x000000100000 : "boot0"
0x000000100000-0x000000500000 : "uboot"
0x000000500000-0x000000600000 : "secure_storage"
0x000000600000-0x000000800000 : "sys"
sunxi:sunxi-spinand-phy:[INFO]: phy blk 1023 is bad
sunxi:sunxi-spinand:[INFO]: not find boot_param in flash
sunxi:sunxi-spinand:[INFO]: Try sample param is sample mode:1 right_delay:35
.....
ubi0: attaching mtd3
ubi0: scanning is finished
ubi0: attached mtd3 (name "sys", size 122 MiB)
ubi0: PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 126976 bytes
```

```
ubi0: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 2048
ubi0: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096
ubi0: good PEBs: 975, bad PEBs: 1, corrupted PEBs: 0
ubi0: user volume: 9, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
ubi0: max/mean erase counter: 2/1, WL threshold: 4096, image sequence number: 0
ubi0: available PEBs: 12, total reserved PEBs: 963, PEBs reserved for bad PEB handling: 19
ubi0: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 268
ubi: mtd3 is already attached to ubi0
```

Model: flash 型号

Munufacture: 厂家型号

DieCntPerChip: 每个芯片有多少个 die

BlkCntPerDie: 每个 die 有多少个 block

PageCntPerBlk: 每个 block 有多少个 page

SectCntPerPage: 每个 page 有多少个扇区

OobSizePerPage: 每个 page oob 区域大小

MaxEraseTimes: 最大擦除次数

TotalSize: flash size

SectorSize: 每个扇区大小

PageSize: 页大小

BlockSize: 块大小

phy blk 1023 is bad: 1023 为坏块

sample mode:1 right_delay:35: 代码 spi 控制器的采样模式, 由于电路的传输延时和 nor 设备接受命令后的响应延时, 我们在读取数据时, 发送完成命令后, 需要 delay 一段时间, 再发送 clock 进行数据读出, 确保数据的准确性, 启动对应的采样模式 (sample_mode) 和采样延时 (sample_delay), 要烧写时 try 出来, 然后启动更新到设备树的。

4 sunxipart partitions: 一个 4 个 mtd 分区, 对应的起始地址、结束地址和分区名字

起始地址	结束地址	分区名
0x000000000000	0x000000100000	"boot0"
0x000000100000	0x000000500000	"uboot"
0x000000500000	0x000000600000	"secure_storage"
0x000000600000	0x000000800000	"sys"

8 调试方法

挂载 debug 调试节点

```
mount -t debugfs none /sys/kernel/debug/
```

查看 spinand 工作频率

```
echo freq > /sys/kernel/debug/spinand/param  
cat /sys/kernel/debug/spinand/status  
100000000 //100M
```

查看 spinand 工作模式

```
echo mode > /sys/kernel/debug/spinand/param  
cat /sys/kernel/debug/spinand/status  
QUAD //4线
```

查看 spinand flash 相关信息

```
echo info > /sys/kernel/debug/spinand/param  
cat /sys/kernel/debug/spinand/status
```

```
===== arch info =====  
Model:      GD5F1GQ4UBYIG  
DieCntPerChip: 1  
BlkCntPerDie: 1024  
PageCntPerBlk: 64  
SectCntPerPage: 4  
OobSizePerPage: 64  
BadBlockFlag: 0x0  
OperationOpt: 0x7  
MaxEraseTimes: 50000  
EccFlag:     0x1  
EccType:     10  
EccProtectedType: 4  
=====
```

9 FAQ

9.1 dram 全盘扫描

使用 DragonHD 工具全盘扫描 dram，排查是否为 dram 稳定性问题。



图 9-1: DragonHD tool

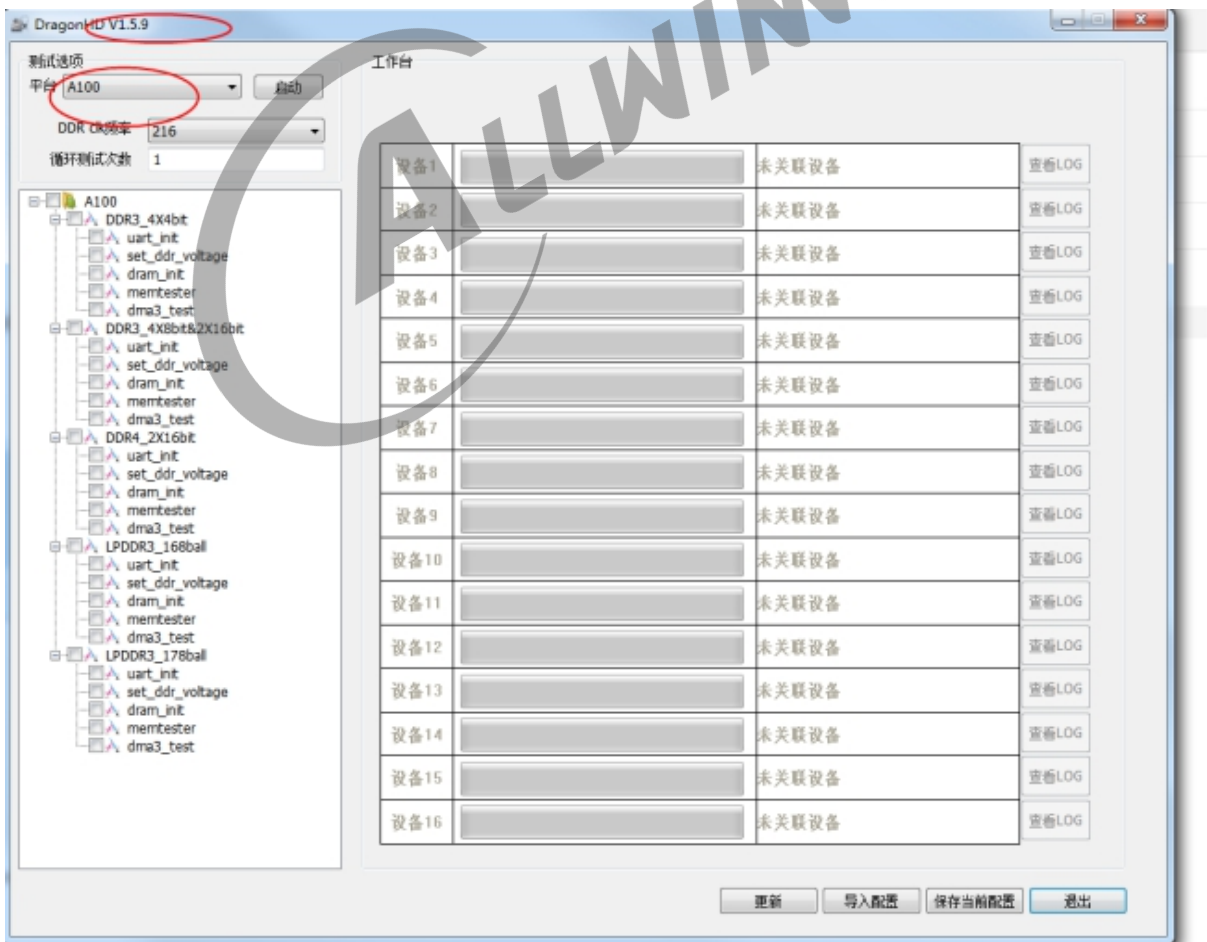


图 9-2: DragonHD tool

9.2 启动失败

根据启动阶段划分启动失败场景：

1. Brom启动boot0失败: 罕见, boot0烧写的有问题
2. boot0读uboot失败: 比较少见, 建议做dram全盘扫描实验
3. uboot启动失败
 - * uboot nand驱动初始化失败
 - * uboot加载、校验kernel, env等逻辑分区失败
4. kernel启动失败
 - * kernel启动时异常崩溃
 - * kernel挂载文件系统异常

9.2.1 brom 启动 boot0 失败

- 现象：串口无 boot0 运行标志打印 “HELLO! SBOOT is starting!” 或 “HELLO! BOOT0 is starting”
- 建议：

1. 做 dram 全盘扫描实验, 排除烧写时 dram 稳定性问题
2. 请 FAE 检查 boot_select 配置
3. 有可能是 boot0 大小过大, 做裁剪 boot0 大小实验
4. 若仍无法定位, 交由全志工程师分析处理

9.2.2 boot0 读 uboot 失败

- 现象：串口出现打印 “Can’ t find a good Boot1 copy in nand.” 或 “Can’ t find a good Boot1 copy in spi nand.”
- 建议：做 dram 全盘扫描实验, 排除 dram 稳定性问题, 若仍无法定位, 交由全志工程师分析处理。

9.3 Ubifs scanning 时间过长

- 1、优先考虑 spi 的工作频率, 工作线宽, cpu 的频率, 通过指令测试读性能是否正常。

```
#time dd if=/dev/mtd3 of=/dev/null bs=4096 count=10240
```

命令分析：

- time: 命令常用于测量一个命令的运行时间。
- dd: 用指定大小的块拷贝一个文件, 并在拷贝的同时进行指定的转换。
- if=文件名: 输入文件名, 缺省为标准输入。即指定源文件。 < if=input file >
- /dev/mtd3: 物理分区, 根据你实际使用情况选择, 对它的读取会产生IO
- of=文件名: 输出文件名, 缺省为标准输出。即指定目的文件。 < of=output file >
- /dev/null: 是一个伪设备, 相当于回收站, of到该设备不会产生IO (也可以指定存在的文件, 但会产生IO)
- bs=bytes: 同时设置读入/输出的块大小为bytes个字节。

count=blocks: 仅拷贝blocks个块，块大小等于ibs指定的字节数。

2、检查内存适配器，导致 attach 较长的主要原因可能是是内存分配器的不同，我们内部默认配置是用 slub, slob 分配时容易引起内存碎片，导致性能问题。slub 分配器是 slab 分配器的进化版。

解决办法：改为用 slub 内存分配器，.config 文件修改 CONFIG_SLUB=y

9.4 Flash 分区与使用说明大小不一致

问题描述：

1. rootfs 分区设置为 96MB，按 512 扇区计算，size 设置为 196608，但是挂载后实际只有 86.8MB。为什么变小了？计算有问题吗？怎么计算的？
2. cat /proc/mtd 擦除块为什么是 0x3F000，但是 boot 分区是 0x40000

```
#
# df -h
Filesystem      Size      Used Available Use% Mounted on
ubi0_5          86.6M     17.1M      69.5M   20% /
devtmpfs       118.0M    0          118.0M   0% /dev
tmpfs          122.1M    0          122.1M   0% /dev/shm
tmpfs          122.1M   776.0K     121.4M   1% /tmp
tmpfs          122.1M    96.0K     122.0M   0% /run
# cat /proc/mtd
dev:   size  erasesize  name
mtd0: 00100000 00040000 "boot0"
mtd1: 00400000 00040000 "uboot"
mtd2: 00100000 00040000 "secure_storage"
mtd3: 0fa00000 00040000 "sys"
mtd4: 0007e000 0003f000 "mbr"
mtd5: 0103e000 0003f000 "backup"
mtd6: 000bd000 0003f000 "env"
mtd7: 0081f000 0003f000 "boot"
mtd8: 0013b000 0003f000 "private"
mtd9: 06039000 0003f000 "rootfs"
mtd10: 0042f000 0003f000 "params"
mtd11: 06039000 0003f000 "data"
mtd12: 01332000 0003f000 "UDISK"
#
```

图 9-3: 分区信息

问题一：

df 显示的是文件系统大小，文件系统本身需要额外的空间存储元数据，导致实际空间会比分区大小少。

ubifs 文件系统本身会占用一些空间来管理数据。3 个 LEB + 5% 日志 + LPT (LPT 消耗是动态，按分区比例的) 大概会少了 10% 左右，有损耗是正常的，文件系统 ubifs 格式要求的。

编号	数据类型	说明	用途
1	superblock area	超级块域 (LEB0)	占用一个LEB存储superblock node, 一般来说, superblock node保存文件系统很少变化的参数。 superblock node仅仅占用LEB0的前4096个字节。
2	master area	主节点域 (LEB1, LEB2)	存储主节点, 包含了所有flash上没有固定逻辑位置的结构。占用LEB1 LEB2. 一般情况下, 这两个LEBs保存着相同数据, master node尺寸为512 bytes, 每次写入master node会顺序的使用LEB的空闲page, 直到没有空闲page时, 再从offset zero开始写master node, 这时会重新unmapped LEBS为另一个erased LEB。 注意, master node不会同时unmapped两个LEBs, 因为这会导致文件系统没有有效master node, 如果此时掉电, 系统无法找到有效master node。
3	log area	日志域(占leb_cnt的5%)	是ubifs日志(journal)的一部分, 目的是为了减少对flash上的索引(index)的更新频率, log size在文件系统创建的时候被固定, log area永远不会耗尽空间。 It is the purpose of the log to record where the journal is.
4	LEB properties tree area	属性树域(LPT)	管理同种类型的LEBs。当前LPT area的尺寸是根据LEB size以及文件系统创建时的最大LEB数计算的。 和log area一样, LPT area永远不会耗尽空间; 和log area不同的是LPT area不是顺序的, 而是随机的。和index一样, LPT区仅仅在commit时更新。
5	orphan area	孤立域(1 leb)	是一个固定数量的擦除块, 位于属性树域和主域之间, 一般来说, 占用一个LEB足以
6	main area	主域	包含了形成文件系统的数据和索引组成的节点

图 9-4: UBIFS 数量类型及损耗说明

问题二：**逻辑擦除块 (LEB) 与物料擦除块 (PEB)**

block size = 128k 为例

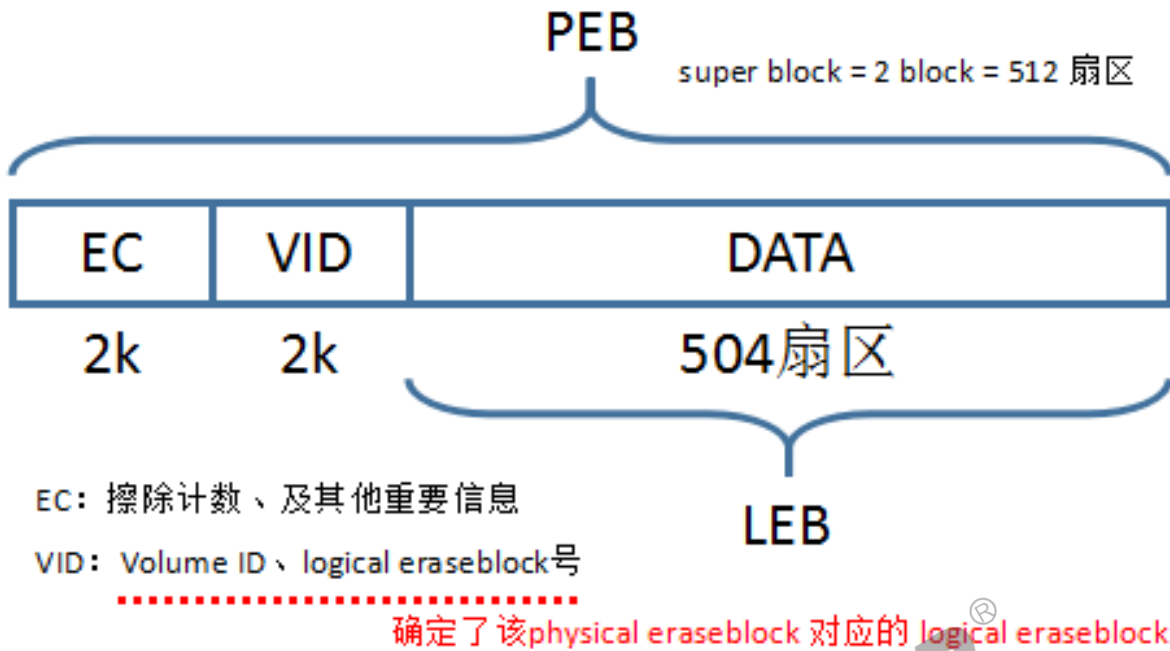


图 9-5: PEB-LEB

mtd4 - 12 走的是 UBI 架构，所以擦除单位是 LEB: 0x3F000，mtd0 - 3 的擦除单位是 PEB: 0x40000

9.5 fat 挂载在 mtdblock 设备上，sync 数据没有写下

问题描述：fat 挂载在 mtdblock 设备上，sync 数据没有写下（sync 后断电，重启后文件数据不存在）

原因：

- 1.sync 不保证数据落盘
2. 可以使用 fsync 保证数据落盘 s




著作权声明

版权所有 ©2024 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

、、**全志科技**、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。